



나노소자공정실 입실 안전교육

UNIST UCRF

1. 클린룸 정의

- 2. 시설 이용
- 3. 보유 장비
- 4. 공동 이용 수칙
- 5. 화공약품 취급 요령
- 6. 비상시 조치 요령
- 7. 장비 예약 / 실적 입력

★ 클린룸 정의

1. Clean room 이란?

- 실내 공기중의 먼지, 미립자를 규정된 청정도 이하로 관리하고 실내의 압력, 습도, 온도, 기류의 분포와 속도 등을 일정범위 내로 제어하기 위해 만들어진 특수한 방으로,
- 실내 작업환경의 오염방지를 목적으로 청정도를 얻고 유지관리 하는 것을 말하며,
- 근래에 와서는 산업기술의 고도 발전으로 인하여 높은 청정도가 전 산업 분야에 요구됨.

2. Clean room 종류

클린룸은 실의 용도에 따라 크게 산업용 I.C.R(Industrial Clean Room)과 의료용 B.C.R (Biological Clean Room) 두 가지로 나누어 짐.

① 산업용 클린룸(I.C.R)의 적용 분야

- 전자제품 생산 공정 : 반도체, LCD, PDP 제작 공정, 컴퓨터 조립 공정 등
- 정밀기계 생산 공장 : 광학렌즈, 필름제조, 시계, 카메라, 현미경, 레이저 기기 제작 공정
- 금속 및 비금속 생산 공장 : 베어링 제품 제조 공정, 정밀 세라믹 제품 제조 공정 등

② 의료용(바이오) 클린룸(B.C.R)의 적용 분야

- 병원수술실 : 공기중의 세균 제거를 필요로 하는 무균 병실, 무균 수술실 등
- 동물실험실(G.L.P_Good Laboratory Practice) : 생체시험 이나 동물실험을 하는 분야
- 약품, 식품을 생산하는 시설(G.M.P_Good Manufacturing Practice)

★ 클린룸 정의

3. 청정도 Class의 의미

1) Class의 단위

Class의 단위는 1(ft³) 안에 있는 0.5(μm) 이상의 먼지의 개수를 기준으로 함.

[참고] 1평방피트(ft³) = 가로 30.43cm * 세로 30.43cm * 높이 30.43cm

단위		파티클 개수		기준
		개/m ³	개/ft ³	
CLASS	1	35.3 이하	1 이하	0.5마이크론(μm)
CLASS	10	353 이하	10 이하	
CLASS	100	3,530 이하	100 이하	
CLASS	1,000	35,300 이하	1,000 이하	

2) HEPA Filter 및 ULPA Filter 의 기능

- ① 헤파필터는 0.3(μm)의 먼지를 99.97% 까지 제어함.
- ② 울파필터는 0.3(μm)의 먼지를 99.997% 까지 제어함.

3) 양 압 : 클린룸 이라 하면 외부의 공기가 클린룸 안으로 인입 되는 것을 막아줘야 하며, 외부의 공기가 유입되는 것을 방지하기 위하여 압력을 관리함.



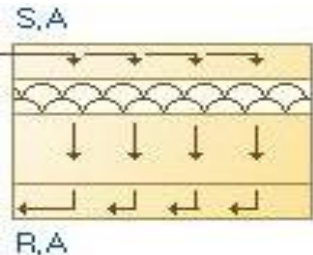
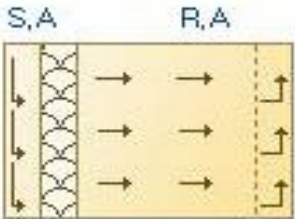
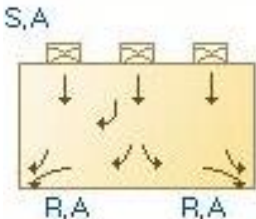
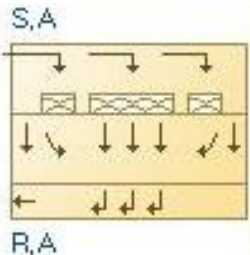
<음압 상태>



<양압 상태>

★ 클린룸 정의

4. Clean room 공조 방식

	Vertical laminar airflow	Horizontal laminar airflow	Tubulent airflow	Mixed airflow	note
Class	1~100	100	1,000~100,000	1,000~100,000	
Cost	high	medium	low	medium	
Layout change	easy	difficult	easy	easy	
Method					



Yellow room



White room

★ 클린룸 정의

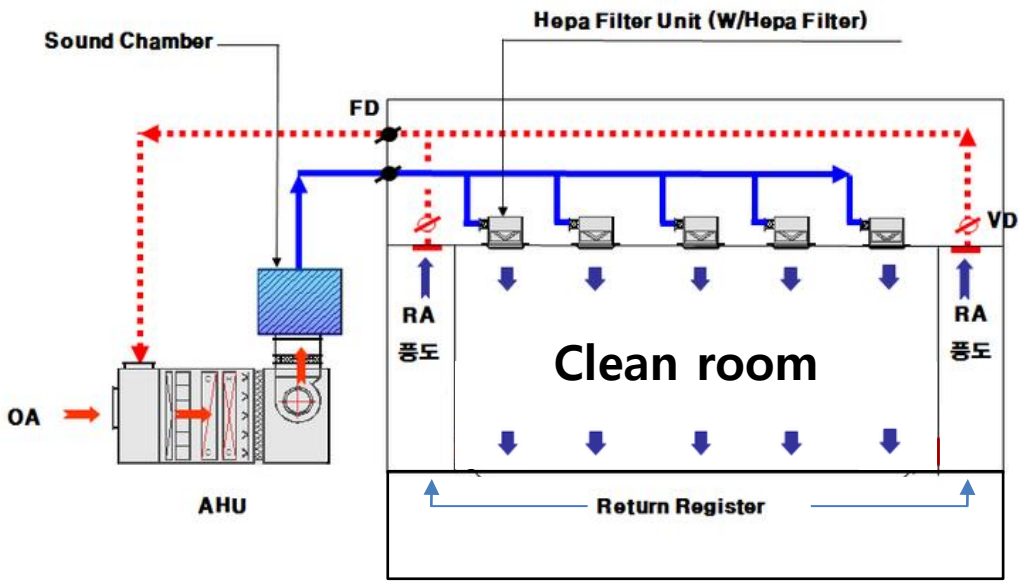
5. 나노소자공정실 청정도 유지 및 관리

1) 공조기 필터 교체 주기

구분	O.A필터(외기)	Pre필터	Medium 필터	HEPA 필터
교체주기	수시	3개월	3 or 6개월	2년

2) 온습도 관리

구분	기간	온도	습도	비고
클린룸	연중	22℃	55%	24시간



<연구지원본부 나노소자공정실 공조>

1. 클린룸 정의

2. 시설 이용

3. 보유 장비

4. 공동 이용 수칙

5. 화공약품 취급 요령

6. 비상시 조치 요령

7. 장비 예약 / 실적 입력

시설 이용

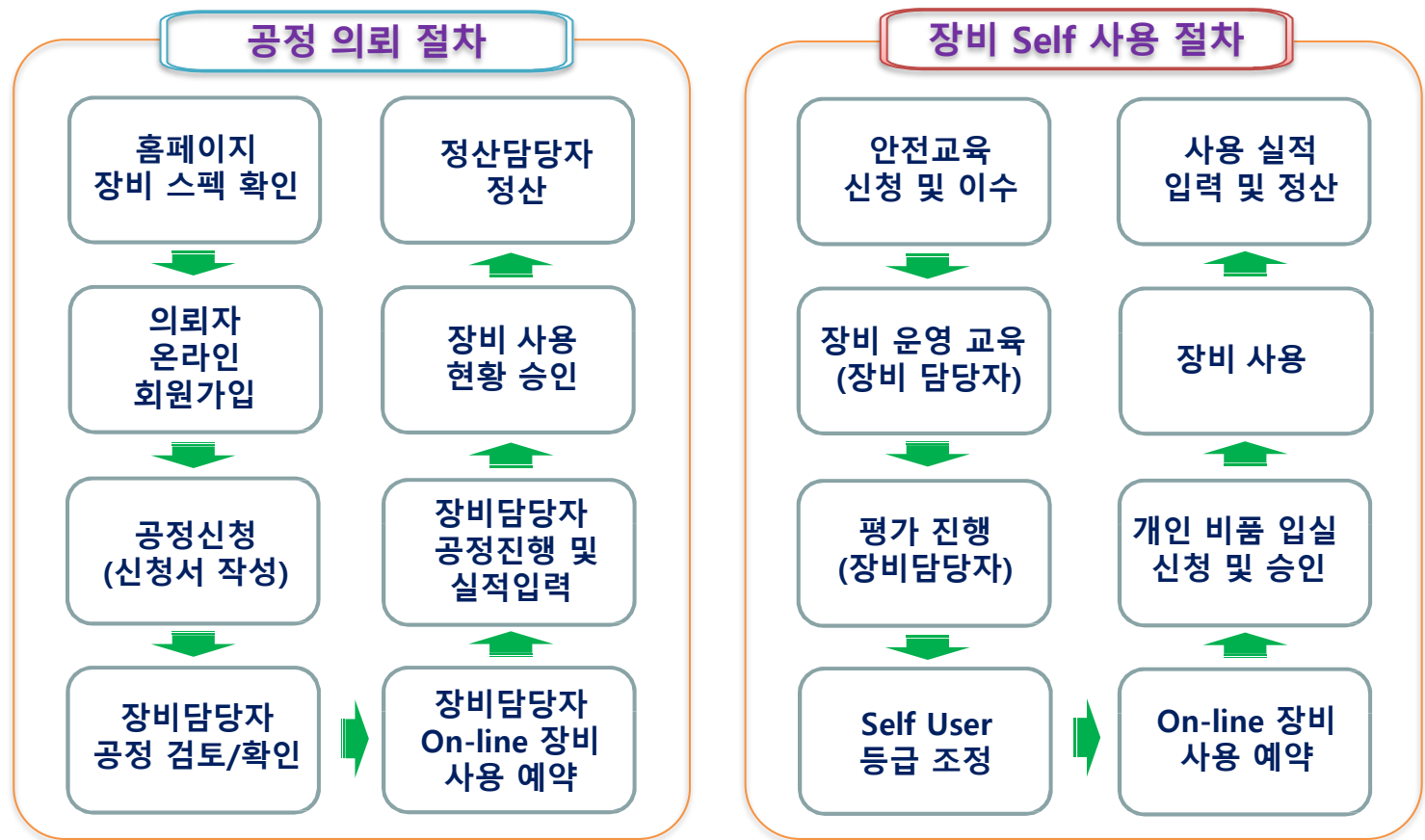
1. 나노소자공정실 이용안내

- 1-1. 이용 가능 시간
- 주중 근무시간 (STAFF 상주 시간: 09:00~18:00)
 - 근무 시간 외 (주말, 공휴일 포함) : 1인 실험 금지
- 1-2. 이용 수칙 준수
- 출입 신청 및 장비 예약 준수
 - 시설 및 장비의 이상 시 즉시 관리자에게 보고
 - 휴일, 주말 시설 이용 시 휴일안전점검일지(#별첨2) 작성 후 제출
- 1-3. 장비/행정 담당자

구분		담당자	연락처	비고
입실자 안전교육 및 입실 문의		황은정	4189/4192	
장비 사용 및 공정 문의	Process, Imprint, Bonder	김민재	4064	
	E-Beam evaporator(Temescal), Sputter(DC/RF/HSC), Cluster ALD, Auto parylene coater, CR Utilities	김형일/김보성	4065/4191	
	PE CVD(SiO2/Si3N4/SiC), LP CVD(Poly/Nit/TEOS), Furnace(Wet/Dry), ALD, Ellipsometer, AFM	강해라/김보성	4167/4191	
	E-beam lithography, Dicing saw#1(Quartz,glass)	이루다	4022	
	Photolithography, E-beam evaporator(Woosung), Wire bonder, Cryogenic probe station	황은정	4189/4192	
	Wet & Dry Etch process, 4-point probe, Normal SEM, CMP&Lapping, RTP, Surface/Optical profiler, Dicing Saw#2(Silicon)	김강오/이선진	4182/4193	
클린룸 시설/안전 관리		김형일	4065	
행정 관련 사항, 투어 및 기타 문의		김민재	4064	

★ 시설 이용

1-4. 나노소자공정실 장비/공정 사용 절차 - <http://ucrf.unist.ac.kr> (회원 가입 및 교육일정 확인)



- ☞ 의뢰 시 UCRF 홈페이지 “장비의뢰신청서” 작성(담당자와 상의 시 생략가능)
- ☞ 클린룸 입실 – 일일 입실 / 장기 입실 가능(1/3/6개월) _ UCRF 홈페이지 출입 권한 신청
- ☞ 휴일/주말 클린룸 출입시 – 휴일안전점검일지 작성 및 지도교수님 서명 후 제출 (#별첨1)
- ☞ 화학약품 반입시 – 화공약품반입신청서/MSDS 제출 및 반입 후 주기표 부착(의무) (#별첨2)
- ☞ 외부 소속 – 셀프교육 전 외부 자율 사용자 서약서 작성 및 제출 (#별첨3)

참조

2. 나노소자공정실 장비 이용 수가

구 분	장비 (Model)	분석 항목	단위	이용료		비고
				내부 (70%)	외부 (100%)	
Photo	E-beam lithography (NB3)	공정	2hr	219,240	313,200	- Pattern 의뢰자 제공
		추가요금	0.5hr	58,460	83,520	
		- 기본 ER/PR 및 Chemical 제공 : AR-P 6200.09, AR-P 671.04, AR-N 7520.18, AR 600-546, AR 300-71, AR 300-46 - Data consulting, Job file making, e-beam resist coating, baking 및 develop 무료				
	E-beam lithography #2 (Attached)	공정	0.5hr	36,540	52,200	
			- 기본 ER/PR 및 Chemical 제공 : AR-P 6200.09, AR-P 671.04, AR-N 7520.18, AR 600-546, AR 300-71, AR 300-46 - Data consulting, Job file making, e-beam resist coating, baking 및 develop 무료			
	Maskless laser lithography	공정	0.5hr	36,540	52,200	
			- 기본 PR 및 Chemical 제공 (GXR601, XT40, DPRI-1549, : AZ5214, AZ4330, AZ9260, nLOF2035, MIF300) - Spin Coater, Wet Station, Oven, Hot plate 무료			
	Photo lithography (MA6#1,#2)	공정	0.5hr	21,980	31,320	- 개인 재료(PR) 사용시 : 30분당 1,800원 할인
			- 기본 PR 및 Chemical 제공 (GXR601, XT40, DPRI-1549, : AZ5214, AZ4330, AZ9260, nLOF2035, MIF300) - Spin Coater, Wet Station, Oven, Hot plate 무료			
	Photo lithography (MDA400S)	공정	0.5hr	18,270	26,100	- 개인 재료(PR) 사용시 : 30분당 1,800원 할인
- 기본 PR 및 Chemical 제공 (GXR601, XT40, DPRI-1549, : AZ5214, AZ4330, AZ9260, nLOF2035, MIF300) - Spin Coater, Wet Station, Oven, Hot plate 무료						

2. 나노소자공정실 장비 이용 수가

구 분	장비 (Model)	분석 항목	단위	이용료		비고
				내부 (70%)	외부 (100%)	
Etch	Wet Station (Wet Station)	공정	1회 (0.5hr)	10,960	15,660	- 총 5대 보유 - 보유 중인 Chemical 이외 사용 시 협의
			- 장기 입실자 무료			
	Deep Si Etcher (Tegal 200)	공정	1회 ≤ 100μm	109,620	156,600	- 100μm 이상 진행시 :별도 협의
		추가요금	100μm	36,540	52,200	
	Dielectric RIE (Labstar)	공정	1회 기준	43,840	62,640	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	Metal RIE (Labstar)	공정	1회 기준	43,840	62,640	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	Dielectric ICP-RIE (FABstar)	공정	1회 기준	65,770	93,960	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	Metal ICP-RIE (FABstar)	공정	1회 기준	65,770	93,960	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	Plasma Treatment System (V15-G)	공정	0.5hr	29,320	41,760	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	Plasma PR Stripper (PTP300)	공정	1회	29,320	41,760	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
	CCP etcher	공정	1회 기준 ≤ 30min	182,700	261,000	- 30분 이상 진행시 : 별도 협의
XeF2 etcher	공정	1회	73,080	104,400	- 추가요금(재료비) : 500원/1Cycle	

2. 나노소자공정실 장비 이용 수가

구 분	장비 (Model)		분석 항목	단위	이용료		비고	
					내부 (70%)	외부 (100%)		
Thin Film	Sputter	DC Sputter (SRN-120)	공정	1회(≤ 500nm)	43,840	62,640	- 특수 타겟 협의 (사용자 준비) - 추가요금 기준 온도: 100℃/30,000원 layer추가 30,000원	
			추가요금	≤ 100nm	7,300	10,440		
		RF Sputter (SRN-120)	공정	1회(≤ 30min)	65,770	93,960		
			추가요금	≤ 30min	65,770	93,960		
		HSC Sputter (SRN130)	DC	공정	1회(≤ 500nm)	43,840		62,640
				추가 요금	≤ 100nm	7,300		10,440
			RF	공정	1회(≤ 30min)	65,770		93,960
				추가 요금	≤ 30min	65,770		93,960
	PE CVD#1,#2 (PEH-600)		공정	1회	65,770	93,960	- 추가요금 ≤SiO ₂ 1μm, ≤Si ₃ N ₄ 0.5μm	
	PE CVD#3 (FABStar-PECVD)		공정	1회	65,770	93,960	- 추가요금 ≤SiC 0.5μm, ≤Si ₃ N ₄ 0.5μm	
	LP CVD_Poly/Nitride (KVL206)		공정	1회 기준 Batch(25장)	219,240	313,200	- 추가요금 ≤D-Poly 0.2μm ≤Si ₃ N ₄ 0.5μm	
	LP CVD_TEOS (VULCAN-V61RL)		공정	1회 기준 Batch(25장)	219,240	313,200	- 추가요금 ≤SiO ₂ 0.3μm,	
	E-beam Evaporator (WC-4000)		공정	1회 기준 ≤ 300nm	65,770 (Single layer)	93,960 (Single layer)	- 6인치 1장 기준 - 재료비 실비 정산 : Au, Ag, Pd, Pt 등 - 특수 metal 및 crucible 사용자 준비	
			추가 요금	layer추가	32,880	46,980		
				100℃	21,920	31,320		
	E-beam evaporator (Temescal_FC-2000)		공정	1회 기준 ≤ 300nm	65,770 (Single layer)	93,960 (Single layer)	-6인치(5장), 4인치(13장) -재료비 실비 정산 : Au, Ag, Pd, Pt 등 -특수 metal 및 crucible 사용자 준비	
			추가요금	layer추가	32,880	46,980		
				100℃	21,920	31,320		
	Atomic layer deposition, Cluster ALD (Lucida D100, Atomic premium)		공정	1회	109,620	156,600	- 추가요금 : 100Å 이상 추가 증착 시 50Å당 40,000원	
					. 100Å 이상 시 별도 협의			
	Auto Parylene Coating system (NRPC-500)		공정	1회 기준	73,080	104,400		

시설 이용

2. 나노소자공정실 장비 이용 수가

구 분	장비 (Model)	분석 항목	단위	이용료		비고
				내부 (70%)	외부 (100%)	
Diffusion	Furnace WET, DRY (KHD-306)	공정	1회 기준 Batch(25장)	219,240	313,200	- 습식 산화막 :1 μ m 기준 - 건식 산화막 :0.3 μ m 기준
	RTP	공정	30분	36,540	52,200	
Packaging	Dicing Saw#2 (NDS-1012)	후공정	장 (A공정)	21,920	31,320	- A공정: Non-pattern - B공정: Pattern - 추가요금: Dicing line 30개 초과 - Glass, Quartz, Si 외 기판 협의
			장 (B공정)	29,230	41,760	
			추가요금 (>30line)	7,300	10,440	
	CMP & Lapping system	CMP	기본료(wf)	73,080	104,400	- 최대 8" wafer
			>1 μ m	73,080	104,400	
		Lapping & polishing	기본료(wf)	43,840	62,640	- 최대 6" wafer
			>200 μ m	14,610	20,880	
	Wire bonder	후공정	1hr	21,920	31,320	- 공정의뢰 불가 - Tip 청구 시 : 50만원

2. 나노소자공정실 장비 이용 수가

구 분	장비 (Model)	분석 항목	단위	이용료		비고
				내부 (70%)	외부 (100%)	
Measurement	Measurement Microscope	측정	1회 기준 ≤ 30min	7,300	10,440	- 장기 입실자 무료
	Surface Profiler (P-6)	측정	1회 기준 ≤ 10min	4,380	6,260	- 장기 입실자 무료
	Thickness Measurement (ST4000-DLX)	측정	1회 기준 ≤ 10min	4,380	6,260	- 장기 입실자 무료
	Surface & Height 3D profiler	측정	1회 기준 ≤ 10min	4,380	6,260	- 장기 입실자 무료
	4-Point Probe System (CMT-SR2000N)	측정	1회 기준 ≤ 10min	4,380	6,260	- 장기 입실자 무료
	Probe station	측정	1Hr	29,230	41,760	
			Low temp. (8hr)	133,630	167,040	
	Ellipsometer (AR06DM)	측정	1회 기준 ≤ 10min	4,380	6,260	-추가요금: 신규 물질 reference data -장기 입실자 무료
			추가요금	7,300	10,440	
	Normal SEM	미세구조물 프로필 분석	시간	29,230	41,760	- 추가 요금 : Sputter 사용
			추가요금	7,300	10,440	
	AFM	측정	30분	18,270	26,100	
입실료	나노소자공정실 입실료	기간별 입실료	7,000/Day 108,000/1M 215,000/3M 380,000/6M			

★ 시설 이용

3. 나노소자공정실(UNFC) 장비 및 시설 배치 현황

Photo
 Thin-film
 Etch
 Diffusion
 Packaging
 Measurement



Bay별 사진



Smock Room



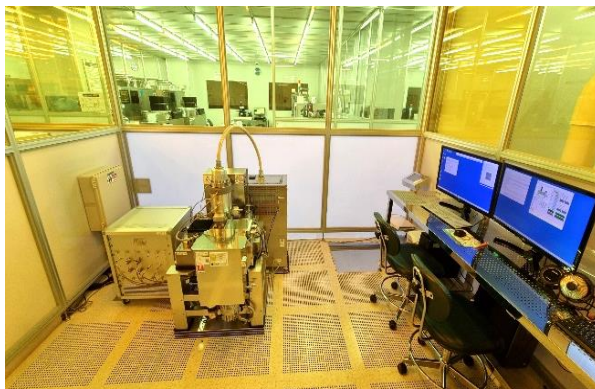
복도



Wet Station



Yellow room



E-beam litho. room



White room#1

Bay별 사진



White room#2



White room#3



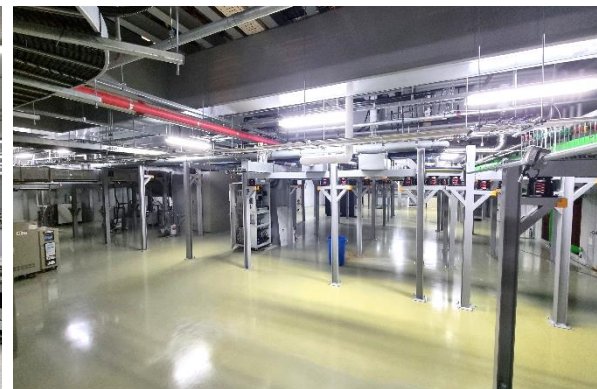
White room#4



Diffusion rom



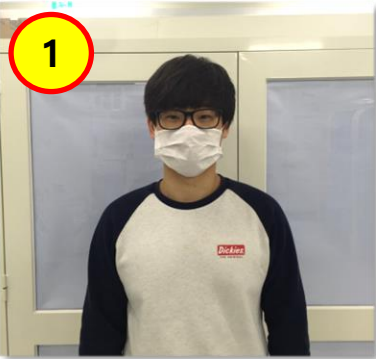
Packaging room



Sub fab

5. 방진복 착용

- 1) 방진복 착용 순서
: 마스크 착용 – 방진 장갑 착용 – 방진모, 방진복 착용 – 방진화 착용
- 2) 방진복 탈의 순서
: 방진화 탈의 – 방진모, 방진복 탈의 – 방진 장갑 탈의 – 마스크 폐기
- 3) 공용 방진복/화는 **사이즈 확인, 정리하여** 원래 장소에 둔다.
: 오염된 경우 세탁함에 넣고 관리자에게 알림



- ❖ 마스크 착용
- 1) 알루미늄 부위를 위로 착용
 - 2) 컷등을 눌러 주었는지 확인
 - 3) 마스크를 정확하게 펴서 사용



- ❖ 방진장갑 착용
- 1) 방진장갑을 먼저 착용
 - 2) 비닐장갑을 착용
 - 3) 장갑 목 부위가 반드시 방진복 소매 끝으로 들어가도록 착용
- ※ 케미컬 사용시 라텍스/니트릴 장갑을 착용



- ❖ 방진모 착용
- 1) 머리카락이 보이지 않게 착용하고, 마스크의 양끝이 방진 모자 안으로 넣어 목 끈을 알맞게 조여서 착용
 - 2) 속살이 보이지 않게 접착 부위 상태 확인
 - 3) 방진 모자의 밑 부분이 나오지 않게 방진복 안으로 넣어야 함



- ❖ 방진복 착용
- 1) 개인 방진복을 착용하며, 없을 경우 공용 방진복을 착용
 - 2) 지퍼불량, 손목부위 고무줄 상태 확인
 - 3) 자신의 Size에 맞는 방진복을 착용



- ❖ 방진화 착용
- 1) 무릎 까지 착용하였는지 확인
 - 2) 고무줄 조임 상태 및 청결 상태를 확인
 - 3) 반드시 자기 Size에 맞는 방진화를 착용
 - 4) 지퍼 상태가 바른지 확인

1. 클린룸 정의

2. 시설 이용

3. 보유 장비

4. 공동 이용 수칙

5. 화공약품 취급 요령

6. 비상시 조치 요령

7. 장비 예약 / 실적 입력

1. Yellow zone - Lithography

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
E-Beam Lithography (NB3, NBL) 	- Theoretical beam size : 2.1nm @ 100 keV, 7nA - Line width : < 5nm - Deflection : vector scan, 55MHz - Address grid resolution : 1nm, 1mm main field - Beam voltage : 30~100keV (normally 80KeV) - Writing area : 195mm×195mm(8inch)	- Beam current - 0.7, 1.0, 3.5nA - PR에 따른 Dose - 671.04 : 8~12 - 6200.09 : 1.5~2.5 - Align mark : 7x10um rectangle - Main/Sub field trim - dxr CAD File
Mask aligner #1/#2 (MA6, SUSS MicroTec) 	- High efficiency & accurate UV exposure system - UV lamp : Hg 350 W - UV 400 : 350~450 nm (I-, H-, G-line) - Gap adjustment accuracy : 1μm - Alignment accuracy : 1μm	- Exposure time - Contact mode - Bake & Develop time
Mask aligner (MDA-400S, MIDAS) 	#1 - Methods : top & back side alignment - Exposure type : vacuum, low vac., proximity, hard, soft, flood-exposure mode #2 - Methods : top side alignment only - Microscope magnification : 90x~500x	- AZ계열 PR 기본 제공 - AZ5214E, nLoF, 4330, 9260

1. Yellow zone - Lithography

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
Nanoimprint lithography (ANT-6H, Elan&KIMM) 	• Curing type : UV, thermal, UV & thermal • Imprint area : ~ 6 inch • Stamp : Quartz, Si, Ni, PDMS, PMMA, etc. • Imprint Pressure : ≤ 2 bar (UV), ≤ 60 bar (Thermal) • UV System : ~ 50 mw/cm² , 2 kW • Temperature : RT ~ 250 °C	• 압력 및 온도 • 압력이 가해지는 속도 • Step별 압력/온도/속도 설정
Spin coater & Bake system (SSP200, SVS) 	• Spin coater - Speed range : Max. 6,000rpm - Speed accuracy : Setting RPM ± 1rpm - Back side rinse(Back side rinse) : 2-Nozzle • position(Acetone) - Coater bowl exhaust : 2-hole exhaust • Hot-plate - Plate flatness : ±10um - Temperature control range : ~200°C	• EBR 및 BR • Hot plate pin up/down을 통한 정확한 시간 통제
Spin coater (Spin-3000A, Midas system) 	• Spin coater - Speed : 300 ~ 7000rpm ± 1% @ no load - Program: 50 steps, 50 recipes(Save&load) - Time: 0.1 ~ 99.9s - Sample size: piece ~ 8inch wafer - Cover inter-lock - Weight: 30Kg	-

1. Yellow zone - Lithography

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
Maskless laser writer (Picomaster200, 4pico) 	• Laser type : 405nm GaN laser diode • Lifetime : > 10,000 hours • Write mode : 0.3um, 0.6um, 0.9um, 5um • NA: 0.85 • Working distance : 0.6mm • Intensity: MAX 3mW in the spot SW controllable • Grayscale level: 4095 levels	• Exposure energy • Minimum line width • Writing time & Direction
FE-SEM with E-beam lithography attachment (SU5000, Hitachi / Elphy multibeam, Raith) 	• Wafer loading size up to 8inch • Resolution: 1.2nm @ 30kV, 2.0nm @ 1kV • Magnification: x10 ~ x600,000(Photo) • Accelerating voltage: 0.5 ~ 30kV • Stage movement: X 0~199mm, Y 0~50mm, Z 3~65mm, T -20° ~ -90°, R 360° • DEBEN beam blanker & faraday cup PCD version • Proximity effect correction and post processing functions	• EBR 및 BR • Hot plate pin up/down을 통한 정확한 시간 통제

★ 보유 장비

2. White zone - Etching

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요parameter
Deep RIE (TEGAL 200, TEGAL) 	• Loading ~ 6inch • Source generator : 5500 W • Dual bias generator : LF 300W(pulse), RF 300W • E-chuck He cooling system(center/edge) • SF₆ / C₄F₈ / O₂ / Ar • Bosch process	• RF Power • Gas 양 및 ratio • Step time(dep vs etching) • Chuck temp • Pressure • Etching time
Dielectric ICP-RIE (Fabstar, TTL) 	• Load lock / process chamber transfer • Loading : 6inch wafer • ICP source power : 2,000 W (1,000W 내외 사용) • Chuck bias power : 500 W (200W 내외 사용) • Back He cooling (chiller :상시 RT, 10 ~ 60°C) • Gas - Metal ICP : SF₆, CF₄, Cl₂, BCl₃, Ar, O₂, N₂ - Dielectric ICP : SF₆, CF₄, CHF₃, Cl₂, BCl₃, Ar, O₂, N₂	• RF Power • Gas 양 및 ratio • Chuck temp • Pressure • Etching time
Metal ICP-RIE (Fabstar, TTL) 		
Metal ICP-RIE#2 (ICP380, Oxford) 	• Load lock / process chamber transfer • Loading : 6inch wafer • ICP source power : 2,000 W (1,000W 내외 사용) • Chuck bias power : 300 W (200W 내외 사용) • Back He cooling (Heating RT~ 200°C) • Gas : Cl₂, HBr, Ar, O₂	• RF Power • Gas 양 및 ratio • Chuck temp • Pressure • Etching time

2. White zone - Etching

장비 (모델,회사)	사양 및 특징	주요parameter
Metal RIE (Lab star-M, TTL) 	• 200 mm electrode with water cooled by chiller • Loading : piece, 4,6 inch • RF generator & auto match network : 500 W, 13.56 MHz solid state • Chuck temp : 15°C	• RF Power • Gas 양 및 ratio • Chuck temp • Pressure • Etching time
Dielectric RIE (Lab star-R, TTL) 	• Metal RIE - MFC BCl₃, Cl₂, SF₆, Ar, O₂ • Dielectric RIE - MFC CF₄, CHF₃, Ar, O₂	
Wet station (Donghun tech) 	• Chemical supply : manual • Temp : ~100°C (Acid/Alkali), 40°C(Solvent) • Batch process : 4, 6, 8 inch • QDR 기능 • Solvent bath : 2대 (Sonicator) • Acid bath: 3대 • Alkali : 1대 • CMP : 1대	• RCA, SPM Cl'n • BOE, Si Etching • PR develop & removing • Lift off

2. White zone - Etching

장비 (모델,회사)	사양 및 특징	주요parameter
CCP etcher (TSP-3055SS, TEL) 	• Wafer loading : FOUP, 25ea • Loading size : ~12 inch • 2 process Ch#, 1loader, 1orienter • RF generator & auto match network : 5kW (Top 60MHz, Bt. 2MHz) • Ceramic E-Chuck temp : -10~60℃ • Ch#1 (12line) - WF6,N2(1),HBr,NF3,SF6,Ar,O2,H2,CF4,CH2F2,CHF3,Cl2,N2(2) • Ch#2 (12line) - C4F8,O2(1),HBr,NF3,SF6,Ar,O2(2),H2,CF4,CH2F2,CHF3,Cl2,N2	• RF Power • Gas 양 및 ratio • Chuck temp • Pressure • Etching time
PR Asher #1 (V15-G, KAMI) 	• Ch# size : 250 x 250 x 250 mm • Microwave power generator : 2.45 GHz, 600W • O₂ , Ar , CF₄ gas control unit : ≥ 200 ml/min	• RF Power(Pulse 기능) • Gas Flow • Ashing time
PR asher#2 (PTP300, KAMI) 	• Ch# size : 300 x 300 x 50mm • Microwave power generator : 600W (2.45GHz) • Temperature: RT ~ 650℃ • Wafer loading: piece ~ 8 inch • Heating: 24 IR lamps (18kW) • Gas lines: N2/O2/Ar	• RF Power • Gas Flow • Ashing time • Temp

3. White zone - Thin-film

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
E-Beam evaporator #1 (FC-2000, Temescal) 	- Thickness uniformity : less than $\pm 5\%$ (6inch) #1 Temescal 15cc, 6 pockets (Au, Al, Ag, Cr, Ti, Ni, Pt, Pd) - Power supply : 6 kW (10kV fix), normal 100mA - Substrate heat 300 °C & Rotation - Loading : 6inch 5매, 4inch 13매 #2 Woosung 7cc, 6 pocket (Au, Al, Ag, Cr, Ti, Ni, Pt, Pd, Cu) - Power supply : 10 kW (8.5kV beam center값) normal 100~200mA - Substrate heat 300 °C & Rotation - 차이점 - Loading 6 vs 1 (6inch 기준) - source 소모량 3 vs 1(100nm 기준) #2 Cu 사용 가능	- e-beam current - substrate heat & rotation - sweep - Cr, Ti seed(최종 두께 10% 이내) - Au, Al, Ag전극용으로 주로 사용
E-Beam evaporator #2 (WC-4000, Woosung) 		
DC Sputter (SRN 120-M, SORONA) 	- Substrate size : piece ~ 6 inch (HSC : 10 slot/cassette) - Substrate rotation speed : 0 ~ 60 rpm - RF pre-cleaning : 300 W / Ar plasma - Number of target : 4 different targets - Thickness uniformity : less than $\pm 5\%$	
RF Sputter (SRN-120, SORONA) 	- DC Sputter - Target : Cr, Al, Ag, W, Mo, Co, - Substrate heating : 300 °C - Power source : 3 kW DC power (실제 1kW 미만 사용) - RF Sputter - Target : ITO, ZnO, SiO₂, Al₂O₃, TiO₂ - Substrate heating : 500 °C - Power source : 13.56 MHz, 1kW RF power (실제 600W 미만)	- Power - Gas : Ar, O₂, N₂ (plasma 생성) - Temp (normally R.T) - roughness개선
HSC Sputtering system (SRN-130, SORONA) 	- HSC Sputter - Target size : 10 inch - Cathode#1(Al, Cr, Zn/ZnO, Pulsed DC 15 kW) - Cathode#2(Ti/TiN, High step coverage, DC 15 kW & 600 W RF power) - Cathode#3(SiO₂) : RF 2kW	

3. White zone - Thin-film

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
PE-CVD #1,2 (PEH-600, SORONA) 	• Loading size : piece ~ 6 inch • Substrate Temperature : ~ 400 °C • Power Supply : 600 W, 13.56 MHz RF Generator • Thickness uniformity : less than $\pm 5 \%$ • Nitride/Oxide 증착 : 100 Å ~ 2 um • #1 - SiO₂, Si₃N₄ deposition - Process gas : SiH₄, N₂O, NH₃, N₂, CF₄/O₂ • #2 - Si₃N₄, SiC deposition - Process gas : SiH₄, NH₃, CH₄, N₂, SF₆/O₂, He	• RF power • Pressure • 온도 • Gas량 및 ratio
PE-CVD #3 (Fabstar-PECVD, TTL) 		
LP-CVD Poly/Nitride (KVL206, KSM) 	• Wafer size : ~ 6 inch silicon wafer • Vertical furnace type(25매 단위 진행) • Thickness uniformity : less than $\pm 3 \%$ • Doped-Poly - process gas : SiH₄ : PH₃ = 1000 : 80 - temp : 530 °C , -dep rate : 35Å/min • Nitride - process gas : DCS : NH₃ 30 : 100 - temp : 785 °C, -dep rate : 25Å/min	• Gas, 온도, pressure & process time • doped poly 면 저항 30Ω/sq
TEOS LP-CVD (VULCAN-V61RL, LEAD Engineering) 	• Wafer size : ~ 6 inch silicon wafer • Vertical furnace type(25매 단위 진행) • Thickness uniformity : less than $\pm 3 \%$ • TEOS Oxide - temp : 600~800°C - process recipe set-up 중	• Gas, 온도, pressure & process time

3. White zone - Thin-film

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
Thermal ALD (Lucida D100, NCD) 	- Substrate size : ~ 8 inch - Uniformity : less than $\pm 2 \%$ - HfO₂, TiO₂, Al₂O₃, ZnO - Thermal ALD - temperature : ~350°C - Precursor sources : 3 (heated 2 sources and H₂O source) - Cluster ALD - temperature : ~450°C - Dual process mode : thermal and plasma - Dual ch# : metal / non-metal 구분	- Chamber 온도 - Source 온도 - Source open time - Cycle
Cluster ALD (Atomic premium, CN1) 		
Auto Parylene Coater (NRPC-500, Nuritech) 	- Dimer type : c, n (type별 자료 확인) - Substrate size : 200 mm X 3ea - Process temperature - Evaporation(vapor heater): Max 250°C - Pyrolizer(furnace heater): Max 1000°C - Chiller(cooler): Max -90°C	Dimer 용량 (1um/3.2g, 5um/20g)

3. White zone - Diffusion

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	주요 parameter
Furnace (Wet Oxidation) (KHD-306, KSM) 	- Wet Oxidation process - Heater spec (2 zone) : 400~ 1100 °C - Wafer size : piece ~ 6 inch, 25매 단위 진행 - Thickness uniformity : less than ± 3 % - dielectric film annealing chamber	- 온도 - Gas : H₂, O₂, N₂ - Process time
Furnace (Dry Oxidation) (KHD-306, KSM) 	- Dry Oxidation process - Heater spec (3 zone) : 400(ITO) ~ 1100 °C - Wafer size : piece ~ 6 inch, 25매 단위 진행 - Thickness uniformity : less than ± 3 % - Metal film annealing chamber	- 온도 - Gas : O₂, N₂ - Process time
Rapid Thermal Processing (Allwin21) 	- Wafer Size : 4~6" wafer & pieces - Tray : Metal, Non-Metal로 구분하여 사용 - Duration time : 0~60s(고온), 300s(저온)/step - Temperature : Max. 1000 °C - Ramp up rate : 10~120 °C/s - Temp Control : Thermocouple & Pyrometer 택 1	- 온도 - Gas : N₂, O₂ (Max. 10 SLM) - Process time

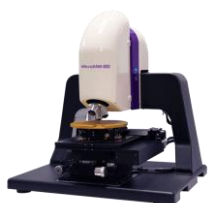
4. White zone - Inspection

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	비 고
Normal SEM (S-3400N, Hitachi) 	- Resolution : 3.0 nm at 30 kV, 10 nm at 3 kV (SE mode) - Magnification : x 5 to x 300,000 (continuous) - Accelerate voltage : 0.3 to 30 kV (0.1 kV/step) - Traverse : X axis 0 ~ 100 mm, Y axis 0 ~ 50 mm	
Inspection microscope#1,#3 (DM4000M, Leica) 	- Magnification(Objective lens) : 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, Magnification(Ocular) : 10x 6-position nosepiece(M32), 4-position turret for filter cubes - Contrast methods RL : BF, DF, Pol, ICR, Fluo - CCD : 1/2 inch, 211 mil-pixel CCD image sensor - Frame rate : 7.5 F/S & 30 F/S (Optional) - Electronic shutter : auto/manual/off, 1/15~ 1/5000	
Inspection microscope#2 (Axio scope A1, CarlZeiss) 	- Magnification(Objective lens) : 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, Magnification(Ocular) : 10x 6-position nosepiece(M32), 4-position turret for filter cubes - Contrast methods RL : BF, DF, Pol, ICR, Fluo - CCD : 1/2 inch, 211 mil-pixel CCD image sensor - Frame rate : 7.5 F/S & 30 F/S (Optional) - Electronic shutter : auto/manual/off, 1/15~ 1/5000	
Ellipsometer (Elli-SE-UaM8, Ellipso Technology) 	- Wavelength range : 240 nm ~ 1000 nm (CCD Type) - Beam spot size : ≥ 1.5 mm - Measuring constants Film thickness, n, k vs λ - Thickness range : sub Å ~ 10 μ - Number of layers Up to 10	

4. White zone - Inspection

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	비 고
Thin film measurement (ST4000-DLX, K-MAC) 	• Detector : used wavelength range is 400 ~ 800 nm • Stage size : 300 mm x 300 mm (12 inch wafer) • Lens : m5x, m10x, m50x • Reflection probe : choose wavelength (300~800nm) • Thickness measurement range : 100 Å ~ 50 μm	
Surface Profiler (P-6, KLA Tencor) 	• Single 2D & 3D scanning profiler • 150mm diameter sample stage • Automatic step detection and multiple cursor • Stylus force : adjustable between 1 ~ 15 mg • L-stylus : 2 um radius 60 degree	
4-Point probe (CMT-SR2000N, AIT) 	• Measurement range : Ω, Ω/sq, Ω/cm • Current source : 10 nA ~ 100 mA • Voltage : 0 ~ 2,000 mV • Substrate size(mm) : ~200(wafer) 140×140(square) • Data analysis : data map, contour & 3D mapping	
AFM (NX20, Park systems) 	• Resolution: 0.01nm • Stage load: piece ~ 6inch • XY measurement area: 100um x 100um • Z stage movement: 25mm • Scanning capacitance microscopy(SCM) • High voltage tool kit ~ ±10V	

4. White zone – Inspection & Package

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	비 고
Cryogenic probe station (CRX-4K, Lakeshore) 	• Measurement of I-V in temperature variation • Temperature : 6 K ~ 340 K • Wafer size : piece ~ 2 inch • Capacitance : 1pF ~ 100nF (Frequency: 1kHz to 10Mhz) • Voltage bias: $\pm 30V$ (Resolution: 1.0mV) • Detector : KEITHLEY (4200-SCS)	
WLI (Microxam 800, KLA) 	• VSI, PSI 3D scan mode (2D Profiling) • Step Repeatability : 1 nm or 0.10% • Vertical Resolution : 0.2 nm • 150mm diameter sample stage • Light Source : White and Green LEDs • Lens : 10x-50x (714 x 546 ~ 143 X 109 Field of View, μm) • X-Y-Z stage Stitching	
CMP (ORBIS, LOGITECH) 	• Head : Twin head system • Carrier Size : 4~8 inch (Speed : 10~100 rpm) • Plate Size : 600 mm (Speed : 100 rpm) • Down Load (Back Pressure) : 0~50 psi (0~9 psi) • Slurry Flow rete : 20~500 ml/min • EPD : Co-efficient system • Slurry : Silica	
Lapping (LP70, LOGITECH) 	• Plate Speed : 5~100 rpm • Jig Speed : 5~100 rpm • Cylinder : 2L x 2ea • Abrasive flow rate : 1~100 ml/min • Auto Plate Flatness ($\pm 0.1 \mu m$), Thickness control ($\pm 1 \mu m$)	

4. White zone – Package

장비 (모델, 회사)	사양 및 특징	비 고
Substrate sawing machine (AR06DM, Aaron) 	- Substrate size : ~ 6 inch - Cutting materials : silicon, glass, quartz & GaAs - X-axis (chuck table horizontal movement) - Work-piece width setting range : 0.01 ~ 160 mm - Cut speed : 0.05 ~10 mm/s or more	
Dicing saw (NDS1012, Neontech) 	- Substrate size : ~ 8 inch - Blade Diameter : 2" Blade - Cutting materials : silicon - X-axis (chuck table horizontal movement) - Work-piece width setting range : 0.01 ~ 160 mm - Cut speed : 0.1 ~400 mm/s	
Wire bonder#1 (HB02, TPT) 	- Ultrasonic system 63 kHz transducer, PLL Control - Ultrasonic power 0 - 1 watt Low / 0 -2 watt High - Bond time 20 - 999 msec. - Bond force 15 - 130 grams - Temperature controller up to 250°C +/- 1°C	

1. 클린룸 정의

2. 시설 이용

3. 보유 장비

4. 공동 이용 수칙

5. 화공약품 취급 요령

6. 비상시 조치 요령

7. 장비 예약 / 실적 입력



공동 이용 수칙

1. 나노소자공정실 이용 수칙

연구지원본부 나노소자공정실(UNFC) 이용 수칙

(나노소자공정실 2021.6.4.)

제1조 나노소자공정실(이하 클린룸) 출입

- ① 클린룸은 24시간 상시 개방하며, 클린룸 입실자 안전교육을 이수하고 평가를 통과한 연구활동종사자만 클린룸에 출입할 수 있다.
- ② 연구지원본부 홈페이지를 통해 1일 단위 또는 1~6개월 단위로 출입 신청이 가능하며, 담당자의 승인 이후 출입증을 이용하여 입·퇴실할 수 있다. 입실 기간에 따라 소정의 입실료가 부과되며, 이미 결제한 입실료는 환불되지 않는다.
- ③ 타인 명의의 출입증을 이용하여 무단으로 출입 또는 동시 입장을 허용하지 않으며, 필히 본인 명의의 출입증을 이용하여 개별 입·퇴실하여야 한다.
- ④ 야간(18:00 ~ 익일 09:00) 또는 휴일 사용자는 출입시 만일의 안전사고에 대비하여 개인의 안전 및 보호수칙(2인 이상 동행 또는 비상연락 조치 등)을 수립하여 출입하여야 한다.
- ⑤ 나노소자공정실 입소에 관하여 위 ①~④항을 위반하는 자는, 해당 위반 행위로 인하여 생기는 모든 안전 및 재산상의 피해에 대하여 배상 의무를 진다.

제2조 클린룸 공간 이용

- ① 야간과 주말 및 공휴일에는 클린룸 출입 경력 최소 6개월 이상인 자만 장비를 사용할 수 있다.
- ② 주말 또는 공휴일에 클린룸을 출입할 경우, 클린룸 전실에 비치된 연구실 휴일안전점검일지(붙임2)를 필히 작성하여야 하며, 해당 연구실의 연구책임자(지도교수)의 친필 서명 확인을 받아 사용일로부터 2일 이내에 제출해야 한다.
- ③ 클린룸 입실자는 전실에 비치된 클린룸 일반 안전수칙을 숙지하고 준수하여야 한다.

- 1) 클린룸 내에서는 화장을 금지하며 금연, 정숙, 정리정돈을 철저히 하여야 한다.
- 2) 클린룸 출입자는 아래 사항을 준수한다.
 - 가. 청정도 유지를 위해 허용된 물품(무진지, 코팅된 종이 등)만 사용 하여야 한다.(연필, 수정 펜 등은 사용 금지)
 - 나. 부품, 장비 등 관리자의 승인을 받은 물품만 반입 가능하며, 물품 반입시 세정 후 반입하여야 한다.
 - 다. 작업대 위에 앉는 행위, 장비에 기대는 행위, 뛰거나, 바닥에 앉는 행위는 금지한다.
- 3) 분석, 공정, 가공 시작 전 장비별 안전수칙을 숙지하여야 한다.
- 4) 반드시 적절한 안전보호구를 착용 후 실험한다.
- 5) 장비, 화공약품 등 사용 전후 이상 유무를 확인하고 이상 발생 시 관리자에게 신속하게 내용을 전달한다.
- 6) 장비 사용 전 반드시 예약하여야 하며 사용 종료 후 실적 입력을 정확하게 한다.
- 7) 연구실 휴일 일일안전점검은 사용자의 해당 연구실 책임자의 승인을 득한 후 클린룸 담당자에게 제출하여야 한다.
- 8) 실험 중 부득이하게 자리를 이탈시 안전조치 및 실험중인 내용을 반드시 게시하여 타인에게 정확한 정보를 전달한다.
- 9) 최종 퇴실자는 주변 정리정돈 및 클린룸의 이상 유무를 확인한 뒤 퇴실한다.
- ④ 입실자는 Smock room에 비치된 청색 방진복(개인용 착용 불가)을 착용 순서에 따라 착용하며, 타인의 방진복을 입거나 더럽히는 행위는 하지 말아야 하며, 탈의 시 정리정돈을 철저히 한다.
- ⑤ 실험 종료 이후 주변 정리를 해야 하며, 장비 또는 환경에 이상이 있을 경우 장비담당자에게 신속하게 고지해야 한다. 고지 의무를 위반하였을 경우 장비 이용 제한을 받을 수 있다.

제3조 클린룸 장비 사용

- ① 클린룸에서 운영 중인 장비를 사용하고자 하는 자는 장비담당자 및 관



공동 이용 수칙

1. 나노소자공정실 이용 수칙

리자의 교육을 이수하고 자격 평가를 통과하여 자율 사용 자격이 부여된 이후 장비를 예약하고 사용하여야 한다. (장비 담당자에게 공정 의뢰는 장비 교육 및 자격 평가와 무관함)

- ② 장비 담당자가 진행하는 정기, 수시 교육(실습 포함)을 이수한 뒤, 숙련도 향상을 위해 **피교육자가 소속된** 연구실의 선임자로부터 실습 교육을 받을 수 있으며, 선임자의 자격은 해당 장비 사용 경력이 1년 이상(직전 3개월 이내 5회 이상 사용한 자) 이어야 한다. 선임자의 교육 진행 시 출입신청은 개별로 하며, 교육 중 발생한 모든 안전, 재산상의 문제는 해당 연구실(**외부인일 경우 소속기관**)에서 책임진다.
- ③ 최근 90일 동안 장비사용 기록이 없을 경우 자율사용자격이 상실되며, 자격을 재취득하고자 할 경우에는 장비담당자 및 관리자가 실시하는 장비교육 및 자격평가를 통과하여야 한다.
- ④ 장비 예약은 유니스트 포털시스템 또는 연구지원본부 홈페이지 (<http://ucrf.unist.ac.kr>)를 통해 가능하며, 예약 시간을 불필요하게 장시간 점유하여 타인에게 피해를 주지 않도록 한다.
- ⑤ 개인사용을 목적으로 반입하는 화공약품 및 기타 물품은 관리자와 사전에 협의를 하여야 하며, 화공약품 반입 신청서와 물질안전보건자료(MSDS)를 제출 후 관리자의 승인 하에 반입할 수 있다.(붙임1 참조)
- ⑥ 장비의 사용 전후 특이사항이 있을 시 담당자에게 반드시 고지한다.

제4조 장비 사용 예약 후 취소

- ① 장비 예약 취소는 장비 사용 시작 시점으로부터 2시간 전까지 사용자가 직접 할 수 있다. 단, E-Beam lithography의 경우 24시간 전까지 취소 가능하다. (※ 취소 기한이 지난 이후에는 취소 불가)
- ② 공정 의뢰 시, 공정 예약 후 담당자에게 사전에 알리지 않고 예약 시간에 나타나지 않은 사용자에게는 예약한 시간의 공정 요금을 청구한다.

제5조 실험실 안전 및 자율사용자 관리

- ① 실험실 안전에 위협을 끼치는 행위 또는 클린룸 이용 수칙을 위반하고 다른 이의 장비 사용에 피해를 주는 행위를 한 경우, [별표1]에 따라 벌점을 부여받고 그에 합당한 조치를 받을 수 있다.
- ② 이용 수칙 위반이 고의적인 것으로 판정되는 경우, 제재가 강화될 수 있으며, 이용 수칙 위반 후 자진 신고하는 경우 제재가 완화될 수 있다.
- ③ 이용 수칙 위반자가 졸업, 퇴사 등의 사유가 예상되어 제재조치가 이행되기 어렵다고 판단되는 경우 제재조치가 이행될 때까지 클린룸 출입을 일시 정지시킬 수 있다.
- ④ 이용 수칙을 위반하여 클린룸의 재산 및 시설에 손해를 입혔을 경우 변상 책임을 진다.
- ⑤ 이용 수칙 위반자가 제재 조치를 따르지 않을 경우, 연구책임자(지도교수, **외부인일 경우 소속기관의 책임자**)가 연대 책임을 진다.

클린룸 일반 이용 수칙

- ☞ 클린룸 입실은 안전교육 이수자만이 가능하며, 자격이 없는 경우 클린룸 관리자에게 문의한다.
- ☞ 클린룸 평일 정규 운영시간은 09:00~18:00이다.
- ☞ 일과시간(09:00~18:00) 이외 클린룸 사용 시 반드시 2인 1조로 입실 및 실험을 진행한다.
- ☞ 클린룸 출입자는 아래 사항을 준수하여야 한다.
 - 무진지 사용 및 불펜 사용
 - 반입 물품은 오염원을 꼭 제거해야 하며, 공정 목적과 관계없는 물품은 반입 금지(반입 시 관리자 승인)
 - 장비에 기대는 행위, 뛰거나(비상시 제외) 작업대(테이블) 및 바닥에 앉는 행위 금지
 - 음식물 섭취 및 화장 금지
- ☞ 실험실 내 비상 대피로 및 소화 기구 비치 장소를 숙지한다.
- ☞ 반드시 적절한 안전보호구를 착용 후 실험한다.
- ☞ 장비/화공약품 사용 전/후 이상 유무 확인 및 이상 발생 시 관리자에게 신속하게 보고한다.
- ☞ 실험 중 부득이하게 자리의 이탈 시 안전조치 및 실험 중인 내용을 게시하여 타인에게 전달되도록 한다.
- ☞ 퇴실자는 전기기구의 전원차단 및 정리정돈을 철저히 한다.



공동 이용 수칙

2. 벌점 부과 기준 및 제재 조치

- 벌점 부과 기준

구분		벌점
가급 위반 행위	독성가스 또는 유독물질 등 위험물질에 노출 위험을 초래	10
	화재 및 사고 발생 위험을 초래	10
	고의적으로 장비를 훼손하는 행위	10
	폐시약통의 보관량이 1/2 이상일때 관리자에게 통보하지 않는 행위	10
	Wet station 사용 또는 폐액 통(waste tank) 처리 관련 작업 시 안전장구 미착용(고글, 방독면, 앞치마, 보호 장갑, 안면보호구등)	10
	폐액 분류를 올바르게 하지 않는 행위(폐액 종류별 구분)	10
	성상별(산, 유기, 알칼리) 지정 chemical bath를 임의로 변경하는 행위	10
	관리자와 사전 협의 없이 전기, 가스, 소방 및 기타 유틸리티를 조작	10
	기타 타인의 안전에 피해를 줄 수 있는 행위	10
나급 위반 행위	예약없이 장비 무단 사용 또는 예약 시간을 초과하여 무단으로 장비 사용	5
	타인 명의의 출입증을 이용하여 출입	5
	타인의 명의로 예약(로그인)하여 장비 사용	5
	사전 협의 없이 장비를 무리하게 사용	5
	타인의 물품(공정 소모품 및 기자재)을 사전 동의 없이 사용하거나 탈취	5
	클린룸 내에서 관리자에게 승인 받지 않은 화공약품 사용 (약품 반입 신청서 미제출 포함)	5
	화학물질을 사용 후 방치하거나 위험을 초래하는 행위	5
	Wet Station 실험도중 사용 중인 화학약품의 정보 및 사용 예상시간, 소속, 이름, 연락처 등의 정보를 담은 메모를 남기지 않고 자리 이탈 행위	5
	기타 안전에 위해를 가하거나 장비에 피해를 입힐 수 있는 행위, 기타 클린룸 이용 수칙을 위반한 행위	5
다급 위반 행위	장비 사용 후 사용 실적 미 입력 또는 허위 입력 행위	3
	방진복 착용 방법 위반 및 청정도에 영향을 미치는 행위(화장 등)	3
	클린룸에서 사용이 허가되지 않는 물품을 사용하는 행위(청정도 유지)	3
	지정된 후드 외에서 Hot plate 및 약품을 사용하는 행위	3
	교체된 장비 부품, 사용한 공정 소모품, 시편 등을 장시간 방치 행위	3
	안전교육 미 이수자를 관리자의 동의 없이 출입하도록 돕는 행위	3
	약품을 지정되지 않은 위치에 보관하거나 방치하는 행위	3
	물품 및 장비 반입 규정 위반(노트북, 아이폰 등 실험 용도 제외)	3
	클린룸 내부에서 뛰거나, 장비에 기대거나, 바닥에 앉는 행위	3
	기타 클린룸의 실험실 안전 및 타인의 장비사용에 피해를 주어 제재가 필요하다고 판단되는 행위	3

- 제재 조치 기준

구분	누적 벌점	조치 내용
개인에게 부과된 누적 벌점	10점	해당 장비 1개월간 사용 정지
	15점	해당 장비 3개월간 사용 정지 또는 클린룸 제반 환경에 피해를 입혔을 경우 1개월간 클린룸 출입 정지
	30점	3개월간 클린룸 출입 정지
동일 연구실 소속 구성원에게 부과된 누적 벌점	40점	해당 연구실 소속 구성원의 1개월간 해당 장비 사용 금지
	50점	해당 연구실 소속 구성원의 1개월간 클린룸 출입 정지

<참고사항>

- 벌점 부과 기준

가. 사용자의 행위가 벌점 부과 기준에 해당하는 경우 벌점을 부과한다.
(제재 조치 이후 사용을 재개할 때는 이전의 벌점 내역은 1년간 유지되며, 누적 점수에 따라 추가 제재를 가할 수 있다.)

- 제재 조치

가. 누적 벌점이 제재 조치 기준에 해당하는 경우 해당 제재 조치를 취한다.
나. 조치 시행시, 해당 내용을 본인과 해당 연구실 연구책임자(지도교수)에게 메일로, 해당 학과에는 공문으로 통보하며 클린룸 게시판에 게시한다.



공동 이용 수칙

3. 나노소자공정실 사용 Gas

불활성

독성, 가연성

조연성

부식성

Process	Equipment	PN ₂	GN ₂	He	Ar	O ₂	CF ₄	CHF ₃	SF ₆	C ₂ H ₄	SiH ₄ 5%	SiH ₄ 100%	H ₂	NH ₃	BCL ₃	CL ₂	C ₄ F ₈	GeH ₄	N ₂ O	CH ₄	DCS	PH ₃	HBr	비고
Photo	Mask aligner	O																						
	Nano Imprinter		O																					
	Spin coater		O																					
	PR Wet station		O																					
Etch	Dielectric RIE	O	O		O	O	O	O																
	Metal RIE	O	O		O	O			O						O	O								
	Deep RIE	O	O	O	O	O	O		O								O							
	PR Strip		O		O	O	O																	
	Dielectric ICP-RIE	O	O		O	O	O	O	O						O	O								
	Metal ICP-RIE	O	O		O	O	O		O						O	O								O
	Metal ICP-RIE#2		O		O	O										O								O
	Wet station		O																					
Thin film	Furnace (Oxide)	O				O							O											
	Furnace (POCl ₃)	O				O																		
	PE CVD (SiO ₂ , Si ₃ N ₄)	O	O			O	O				O			O					O					
	UHV-CVD	O			O					O	O		O						O					
	RF Sputter	O	O		O	O																		
	DC Sputter	O	O		O	O																		
	Evaporator	O			O																			
	SAM Coater	O			O	O																		
	LP CVD (D-Poly, Si ₃ N ₄)	O	O									O		O							O	O		
	PE CVD (SiC, Si ₃ N ₄)	O	O	O		O			O		O	O		O						O				

1. 클린룸 정의

2. 시설 이용

3. 보유 장비

4. 공동 이용 수칙

5. 화공약품 취급 요령

6. 비상시 조치 요령

7. 장비 예약 / 실적 입력

★ 화공약품 취급요령

1. 화학약품 취급 안전 수칙

안전 수칙

1. 모든 화공약품을 사용하는 자는 사전에 안전교육을 받고 안전 수칙을 이해하고 숙지해야 한다.
2. 응급조치 도구(비상구, 소화기, 산소마스크 등, 특히 세안기)가 있는 장소를 숙지해야 한다.
3. 모든 화공약품은 배기가 잘 되는 wet station에서 사용해야 하며 화공약품을 사용하는 장소에서는 콘택트렌즈를 절대 끼지 말아야 한다.
4. 화공약품, 도구는 사용하지 않을 경우에는 반드시 지정된 보관 장소(Chemical storage cabinet)에 보관해야 한다.
5. 산과 유기용제는 서로 다른 장소에 보관해야 하며 운반 및 폐기할 때에도 격리시켜 실시해야 한다.
6. 산과 유기용제를 혼합하면 폭발물이 형성될 수 있으며 심각한 저해를 유발할 수 있으므로 종류를 불문하고 절대로 섞거나 Wet Station 내에서 혼용하여 사용해서는 안 된다.
7. 모든 화공약품 용기에는 표지를 부착하여 구분할 수 있도록 해야 한다.
8. 화공약품을 사용 시 튀거나 흘리지 않도록 조심하고 사용 후에는 잘 막은 후 보관하며, 마개 부분에 약품이 묻은 경우 물에 적신 와이퍼로 제거하여 보관한다.
9. 화공약품 취급 전 반드시 적절한 안전 보호구를 착용하여야 하며, 착용하기 전에는 점검을 철저히 해야 한다. 특히 장갑류는 착용하기 전에 바람을 넣어 미세 구멍이 있는지 점검 후 사용해야 한다.
10. 미지의 액체는 절대로 임의로 판단하여 만지지 말아야 한다. Wet-station 내부의 떨어진 용액에 대하여 본인이 짐작하여 판단, 처리를 하여서는 안된다. 리트머스 용지를 사용하여 성분 파악 후 해당 약품의 처리 규정을 따라야 한다.
11. 관리자와 협의 및 승인하지 않은 화공약품을 클린룸에서 사용하는 행위를 하여서는 안된다.
12. 성상, 약품별(산, 유기, 알칼리) 지정 chemical bath를 임의로 변경하여 사용하는 행위는 금지한다.
13. Wet station 실험 도중 자리를 이탈하지 않는다.
14. 부득이 이탈 시 약품 종류, 소속과 이름, 연락처를 작성한 메모를 남긴다.
15. Wet-station에서 사용한 개인 실험기구는 실험이 끝나고 각자의 사물함에 보관을 하며, Wet-station 주위를 정리 정돈하여 다음 실험자가 사용하는데 불편하지 않도록 한다.
16. 공동으로 사용하는 화공약품은 기존의 약품을 모두 소진 후 새로운 약품을 개방하여 폐액량을 최소화하도록 한다.
17. 사용한 화공약품은 Chemical storage에 보관하며, 소진된 약품의 빈 용기는 Chemical storage에 넣지 않고, 지정된 폐기물 장소에 보관한다.
18. 실험 후 발생한 폐액은 종류와 양을 20ℓ Bottle에 넣어 폐기하고, 폐액통이 ½ 이상 되면 관리자에게 보고하여 교체 후 사용한다.
19. 화공약품 사용 후 공병은 반드시 D.I로 세척 후 폐액 반납장소로 가져다 놓는다.
20. 화공약품의 폐액 취급 시 안전 보호구를 꼭 착용하도록 한다.
21. 많은 양의 화학약품을 취급할 경우 담당자와 상의하여 진행한다.

★ 화공약품 취급요령

2. 클린룸 화공약품 분류

	산(Acid)	염기(Alkali)	유기(Solvent)
정 의	- 수용액 속에서 전리하여 수소이온 (H ⁺)을 내는 물질	- 수용액에서 전리하여 수산화이온 (OH ⁻)을 내는 물질	- 다른 물질을 용해하기 위해 사용 되는 임의의 액체를 지칭
특 성	- 신맛이 남 - 푸른 리트머스 시험지를 붉게 변화시킴 - 염기와 중화하여 염을 생성 - Fe, Zn 등 금속과 반응해서 수소를 발생시킴 (부식성)	- 쓴맛이 남 - 붉은 리트머스 시험지를 푸르게 변화시킴 - 산과 중화하여 염을 생성 - 미끈미끈한 감촉	- 대부분 가연성이 강함 - 증기를 장시간 흡입하면 두통, 현기증이 발생하며 휘발성이 강함
용도	- 웨이퍼 세척 (cleaning), 식각(etch), 석영 제품 세척 (quartz cleaning), PR 제거(strip) 등의 공정에 사용		- 유기/장비 세척, 사진 감광, 감광막 제거 등의 웨이퍼 가공 공정에 사용
케미컬	- HCl, H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , HF, BOE, H ₂ O ₂	- KOH, NH ₄ OH	- Acetone, IPA, Methanol, PR
사용 용기	- Quartz, Glass, Teflon - HF, BOE의 경우 반드시 Teflon 사용 (Quartz, Glass 사용불가)	- Quartz, Glass	- Glass

HF 사용시



HF 외 케미컬 사용시



3. 혼합해서는 안 되는 화학물질

구분	Acids Inorganic 무기 산	Acids Oxidizing 산화성 산	Acids Organics 유기 산	Alkalis (Bases) 알칼리	Oxidizers 산화제	Poisons Inorganic 무기독성	Poisons Organics 유기독성	Water- reactives 물반응성	Organic Solvents 유기용제
Acids Inorganic 무기 산			X	X		X	X	X	X
Acids Oxidizing 산화성 산			X	X		X	X	X	X
Acids Organics 유기 산	X	X		X	X	X	X	X	
Alkalis (Bases) 알칼리	X	X	X				X	X	X
Oxidizers 산화제			X				X	X	X
Poisons Inorganic 무기독성	X	X	X				X	X	X
Poisons Organics 유기독성	X	X	X	X	X	X			
Water- reactives 물반응성	X	X	X	X	X	X			
Organic Solvents 유기용제	X	X		X	X	X			

★ 화공약품 취급요령

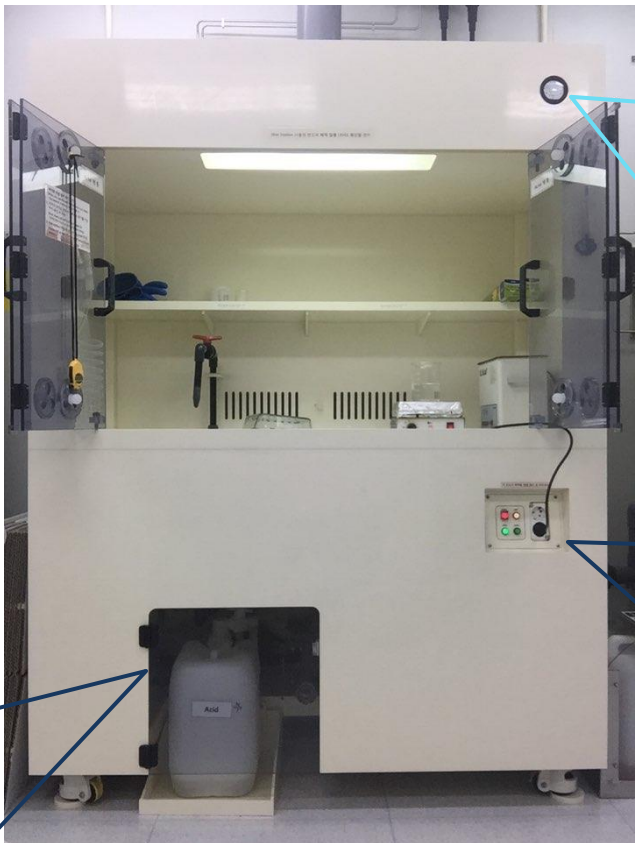
4. Wet Bench 사용법

1. 보호장구 착용

- ① 앞치마
- ② 보호장갑
- ③ 안면 보호구
- ④ 호흡기 보호구

3. 폐액통 레벨 확인

: 레벨 1/2 → 관리자에게 연락



2. 차압계 확인

: 사용 전,후 내부 후드 작동 유무 확인



4. 각종 버튼 조작



5. 배기 모니터링 시스템

★ **알람 발생 시 대응** : 국소 배기가 작용하지 않을 경우 알람 발생

1. 실험 중단
2. Hot Plate와 같은 가열 장치 전원 차단
3. Wet Station 문 폐쇄
4. 담당자 혹은 통합관제실에 연락

★ 화공약품 취급요령

6. 보호 장갑 사용 방법

- 1) 화학물질에 따라 적절한 보호 장갑 사용
- 2) 사용 전 장갑 결함 확인 필수
(공기, 물을 사용하여 결함 상태 확인)
- 3) 사용 후 세척 및 결함 상태 재확인
(사용 후 벗는 방법은 아래 참고)

- 사용 방법



-장갑의 결함 확인 (공기, 물에 넣거나 육안 결함 확인)
-화학약품 잔여 확인
-속 장갑을 필히 착용
-결함 발견 시 담당자와 상의하여 교체



-손목이 드러나지 않도록 착용
-필요시 테이프로 감거나 일회용 팔토시 사용

- 사용 후



장갑을 물로 세척하여 오염원 제거, 물기 제거



장갑을 끝을 잡고 한쪽 손의 절반만 빼낸 후 반대쪽 손의 절반을 뺌



장갑으로 손목이 드러난 부분을 잡지 않도록 유의하여 번갈아가며 장갑을 빼어 냄



실험이 끝나면 속 장갑(PVC)도 폐기하며, 손 씻기

★ 화공약품 취급요령

7. 눈 및 안면 보호구 (고글)



- 사용 방법

Wet Station 내 화학약품을 이용할 경우 눈 보호를 위하여 필히 착용

얼굴 전체를 보호할 수 있기 때문에 안면 보호구 사용을 권장

위생 상 개인 보호구를 소지하고 다니는 것을 권장

사용 전 육안으로 결함 상태 확인

사용 후 화학물질이 튀거나 묻은 경우 와이퍼로 닦아내거나 관리자와 협의하여 교체

★ 화학물질 사용자가 MSDS 상 명시가 되어, 방독면 착용이 필요한 경우, 개인별로 지참하여 착용 권고

★ 화공약품 취급요령

※ 방독면 종류, 착용방법

- 1) 방독면이 필요한 실험을 할 경우 반드시 착용 후 사용한다.
 - 2) 화학물질에 맞게 필터를 착용하여 사용한다.
 - 3) 방독면 착용 방법을 참고하여 밀착검사까지 실시한 뒤 사용한다.
 - 4) 방독면 사용 후 오염이 되지 않도록 밀봉하며 보관하며 사용일, 사용자를 표기한다.
- ※ 방독면이 없으나 응급 시 물에 적신 수건이나 마스크를 대신 사용



- 방독면 착용 방법

1



마스크를 얼굴 위에 대고 머리를 머리 위로 넘긴 뒤 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼운다

2



목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절한다

3



손바닥으로 배기밸브를 막은 후 부드럽게 숨을 내쉰다. 면체가 부풀어오르고 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 양압 밀착검사를 실시

4



손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉰다. 면체가 얼굴 쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 음압 밀착검사를 실시

★ 화공약품 취급요령

8. 실험 보호복

내화학 앞치마 종류	
팔소매 O	팔소매 X
	

- 착용 시 유의할 점
1. 착용 전 결함 확인
 2. 펄럭이지 않도록 뒷부분의 끈으로 앞치마를 고정



3. 화학물질이 묻었을 경우 세척하거나 관리자와 협의하여 교체

- 참고사항

수술 가운 형태로 뒷부분은 개방되어 있으며 앞부분은 산/알칼리/유기를 견딜 수 있도록 코팅 처리된 보호복
 가능한 팔소매가 있는 보호복을 사용하며, 사이즈가 맞지 않아 착용이 어려울 경우 팔토시를 착용하여 팔을 보호할 것
 화학물질을 운반하는 경우에도 착용할 것

★ 화공약품 취급요령

9. 화학물질관리법 주요내용 (유해화학물질 취급자 개인보호구 착용)

취급자의 개인보호장구 착용 (화학물질관리법 제14조)

- 기체 유해화학물질 취급 시
- 액체 유해화학물질에서 증기 발생 우려 시
- 고체 유해화학물질에서 분말이나 미립자 등의 비산 우려가 있을 경우
- 기타 환경부령으로 정하는 경우
 - 실험실 등 실내 공간에서 유해화학물질을 취급하는 경우
 - 유해화학물질을 다른 취급시설로 이송하는 과정에서 안전조치를 하여야 하는 경우
 - 흡입독성이 있는 유해화학물질을 취급하는 경우
 - 유해화학물질을 하역하거나 적재하는 경우
 - 눈이나 피부 등에 자극성이 있는 유해화학물질을 취급하는 경우
 - 유해화학물질 취급시설의 정비·보수작업을 하는 경우

→ 위반 시

- 영업정지 처분
- 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

★벌점 부과 기준, 제재 조치에 기준에 따라 벌점 및 클린룸 사용 제한

구분		벌점
가급 위반 행위	Wet station 사용 또는 폐액 통(waste tank) 처리 관련 작업 시 안전장구 미착용(고글, 방독면, 앞치마, 보호 장갑, 안면보호구등)	10

1. 클린룸 정의
2. 시설 이용
3. 보유 장비
4. 공동 이용 수칙
5. 화공약품 취급 요령
- 6. 비상시 조치 요령**
7. 장비 예약 / 실적 입력

★ 비상시 조치 요령

연구실 번호
(Laboratory No.)

자연과학관
B101

연구실명
(Laboratory Name)

나노소자공정실

연구실 안전담당자
(Safety Manager)

김형일	4065
김민재	4064

원외 주요 연락처
External Main Telephone

소방서 Fire Station	119
경찰서 Police Station	112
좋은삼정병원 Hospital	052)220-7500



화재, 폭발, 가스 · 화학약품
누출 등 응급상황 발생시
Fire, Explosion, Gas
and Chemical Leak etc.

응급상황 발생시
Emergency Call

052) 217-
0119

★ 비상시 조치 요령

1. 의료적 응급조치를 요하는 사고 발생시 조치 요령

내용	조치 방법	비 고
피부에 화공약품이 묻었을 경우	① 화공약품에 오염된 옷을 벗긴다. ② 환부를 15분 이상 흐르는 물로 씻는다. ※ 15분간 씻는 것은 화공약품을 물로 묽게 해주고 중화시켜 주는 첫 단계이므로 상당히 중요하다. ③ 불산 계열의 경우 5분 정도 물로 씻어내고 불산 크림을 도포한다. ④ 의사의 진료를 받는다.	
눈에 화공 약품이 묻었을 경우	① 세안기에서 15분 이상 눈을 씻는다. 이때, 눈꺼풀을 들고 눈동자를 돌려서 물이 골고루 눈에 들어가게 해야 한다. ② 가능한 한 신속히 의사의 진료를 받는다.	
화공약품을 삼켰을 경우	① 화공약품 병의 표시에 지시된 응급처치 방안을 따른다. ② 응급처치 방안이 나와 있지 않을 경우 충분히 많은 양의 물을 마셔 체내의 산이나 알칼리를 희석해야 한다. ※ 절대로 화공약품을 뱉기 위하여 손가락을 입안으로 넣어 강제로 구토를 하지 않는다. (식도 및 기도의 2차 피해 방지)	

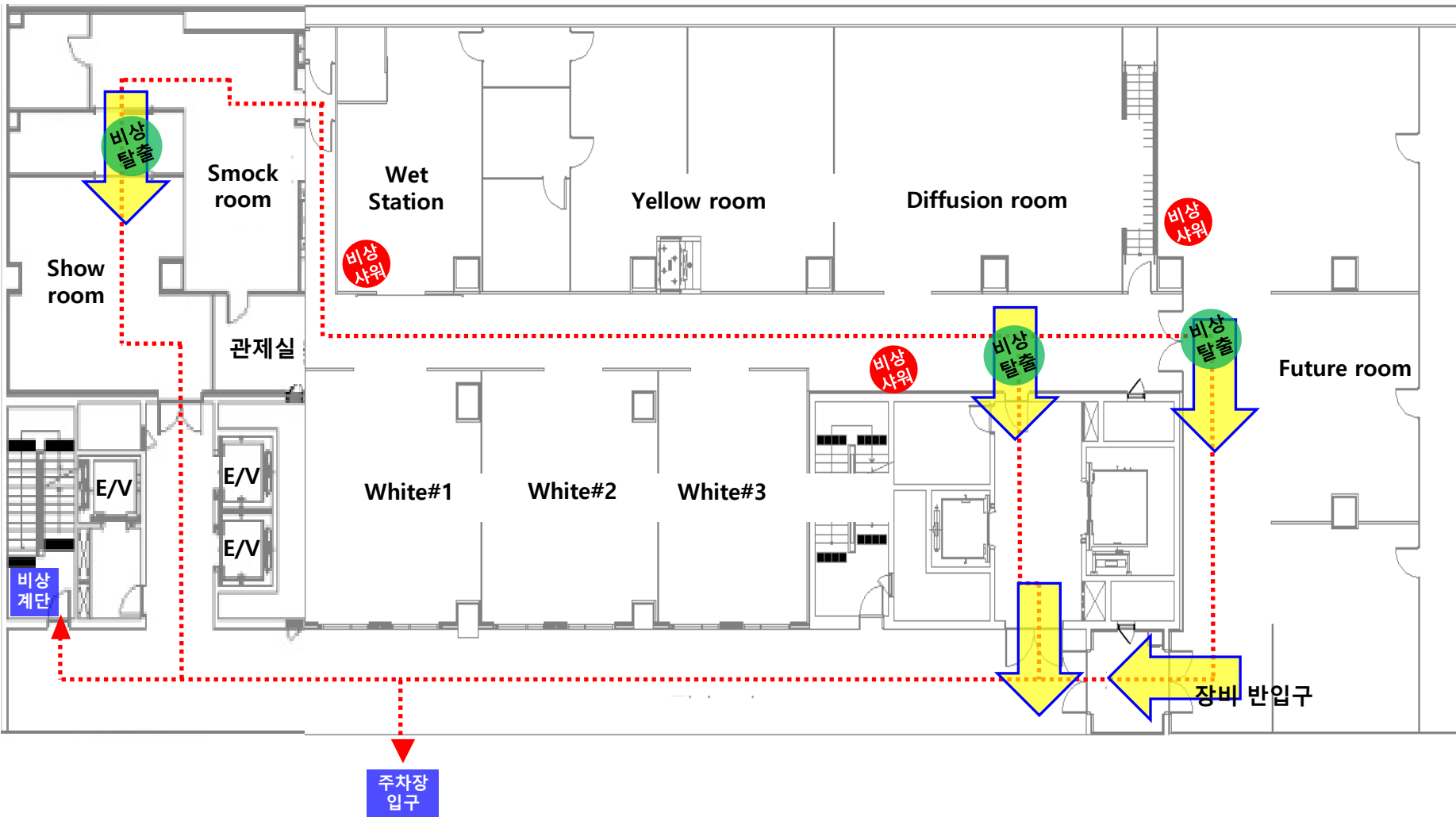
★비상시 조치 요령

2. 화재 경보 발생 시

순서	조치 방법	비 고
화재 경보기 작동	① 방송 스피커에서 화재 경보기 발생 ② 방송 내 화재 위치 및 특이사항을 주의 깊게 청취, 주위 화재 여부 확인 ③ 주위 화재 발생 및 위급한 상황일 경우 즉각 대피	
실험 중단	① 위급한 상황이 아니더라도 진행 중인 실험 즉시 중단 ② 가열기는 전원 차단, 사용 중이던 화학약품은 배기가 되는 곳에 보관 ③ 주변 인원 대피 유도	
비상 대피 경로를 통해 대피	① 위급한 상황이 아닐 경우 입고 있던 방진복, 방진화를 벗는다 ② 비상 대피로를 통해 대피 이때, 엘리베이터 사용 금지 ③ 나노소자공정실 위치 (108동 자연과학관 지하1층)를 잘 숙지하고 지하주차장 혹은 108동 1층으로 대피한다	

★ 비상시 조치 요령

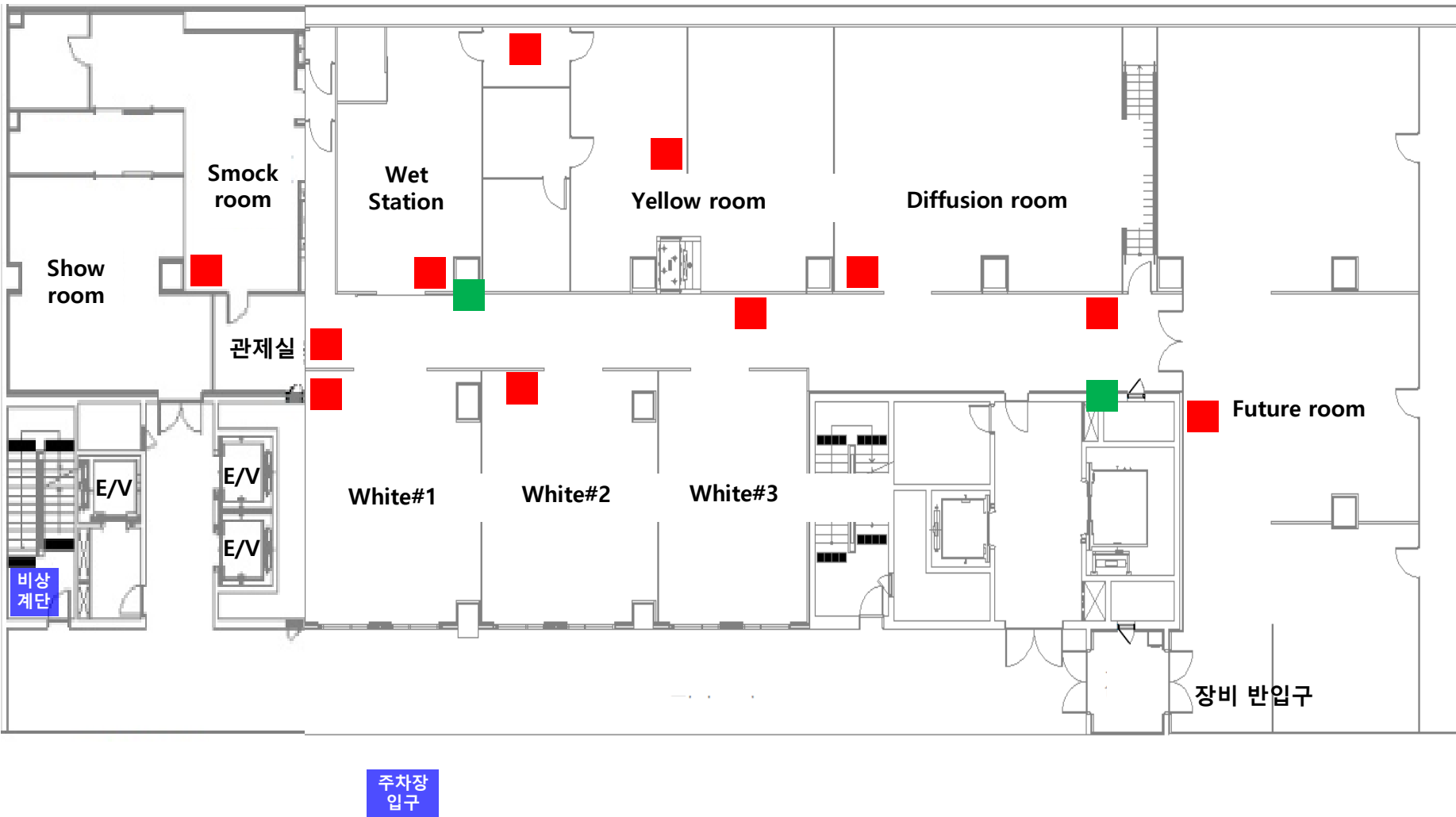
3. 나노소자공정실 비상시 대피 경로 및 비상 샤워 시설



★ 비상시 조치 요령

4. 나노소자공정실 소화기 및 소화전 배치 현황

■ 소화기 ■ 소화전



★ 비상시 조치 요령

5. 화재 사고 발생시 소화기 사용법 및 특징

소화기 사용법



1. 화재 장소로 이동.



2. 안전핀 제거.



3. 바람을 등진다.



4. 노즐은 화염 방향으로 레버를 움켜쥐는다.

❖ 응급조치 가능한 화재 발생시 조치 요령

- 1. 화재 장소로 이동
- 2. 안전핀 제거
- 3. 바람을 등진다
- 4. 노즐을 화염 방향으로 두고 레버를 움켜진다.

❖ 클린룸 내부의 소화기 특징.

- CO₂ 소화기
- 1. 화재 장소 주변의 산소를 없애 소화.
- 2. 사용 후 잔해가 없다는 장점.
- 3. 다량 사용시 산소 확보 필요.

★ 비상시 조치 요령

6. 공기호흡기 사용법



1. 양압 조절기 핸들을 "close"에 두고
By-pass 밸브가 잠겨 있는지 확인한다.



2. 등 지게를 좌,우측에 걸고 멜빵 조임 끈을
이용하여 몸에 고정 시킨다.



3. 호스 플러그를 커플링 소켓에 연결한다.



4. 대기 호흡장치를 "대기 호흡"으로 조정한다.

★ 비상시 조치 요령

6. 공기호흡기 사용법



5. 호흡 장치를 머리에 쓰고 좌,우측 뒤편의 머리 끈을 단단히 고정한다.



6. 용기 밸브를 열어준다.
※ 압력은 295~306kgf/cm²(29~30MPa)



7. 양압 조정기를 "Open"에 위치 시키고, 대기 호흡장치를 "양압 호흡" 으로 둔다.



8. 마스크 내부에 손가락을 넣어 공기 누설 유무를 확인하고, 응급 조치 및 구출 작업을 시작한다.

공기호흡기 사용 동영상

7. 화학약품 누출처리 도구 사용법



CHEMICAL SPILL CARE KIT

화학적 액상물질 누출처리 도구함

1

SAFETY FIRST

안전을 위해서
안전장갑, 호흡기에는
방독면을 착용



2

IDENTIFY SPILL

사용되는 물질의 종류 확인
: 산/알카리/솔벤트
※주의사항: 가연성, 심하게
움직임 그리고 화염에 주의



3

SELECT AGENT

1) 산 : 적색 영문표기



2) 알카리 : 청색 영문표기



3) 솔벤트 : 밤색 영문표기



약품의 공급은
처리지도서를 보고 별도의
사용설명서를 참조

4

TREAT SPILL

Spill-X로 유출물 주변을
둘러싼다.



권장량의 Spill-X를 쏟아
유출물을 덮는다.



유출물과 Spill-X를 완전히
섞고, 반응이 정지하고
혼합물이 식을 때까지 5분
정도 기다린다.

5

RESTORE AREA

만약 유출물이 산/염기였다면,
유출물의 잔류pH를 확인하고
필요할 경우 Spill-X를 더한다.
유출물이 용해되었다면
유출물이 건조분말에 완전히
흡착되었는지 확인한다.



폐기봉투에 처리된 잔류
유출물을 넣고, 필요에 따라
도구들을 소독한다.



★ 비상시 조치 요령

8. 안전 물품



비상기구함(1)
공기 마스크
휴대용 전등
보호복
방진 마스크



비상기구함(2)
보호복
화재대피용 마스크
휴대용 손전등



보호구함
보호복
내화장갑
내화담요
안구 보호구
귀마개



구급약품함
불산크림
소독약, 밴드
손목 스프린트
호흡용 휴대산소 등

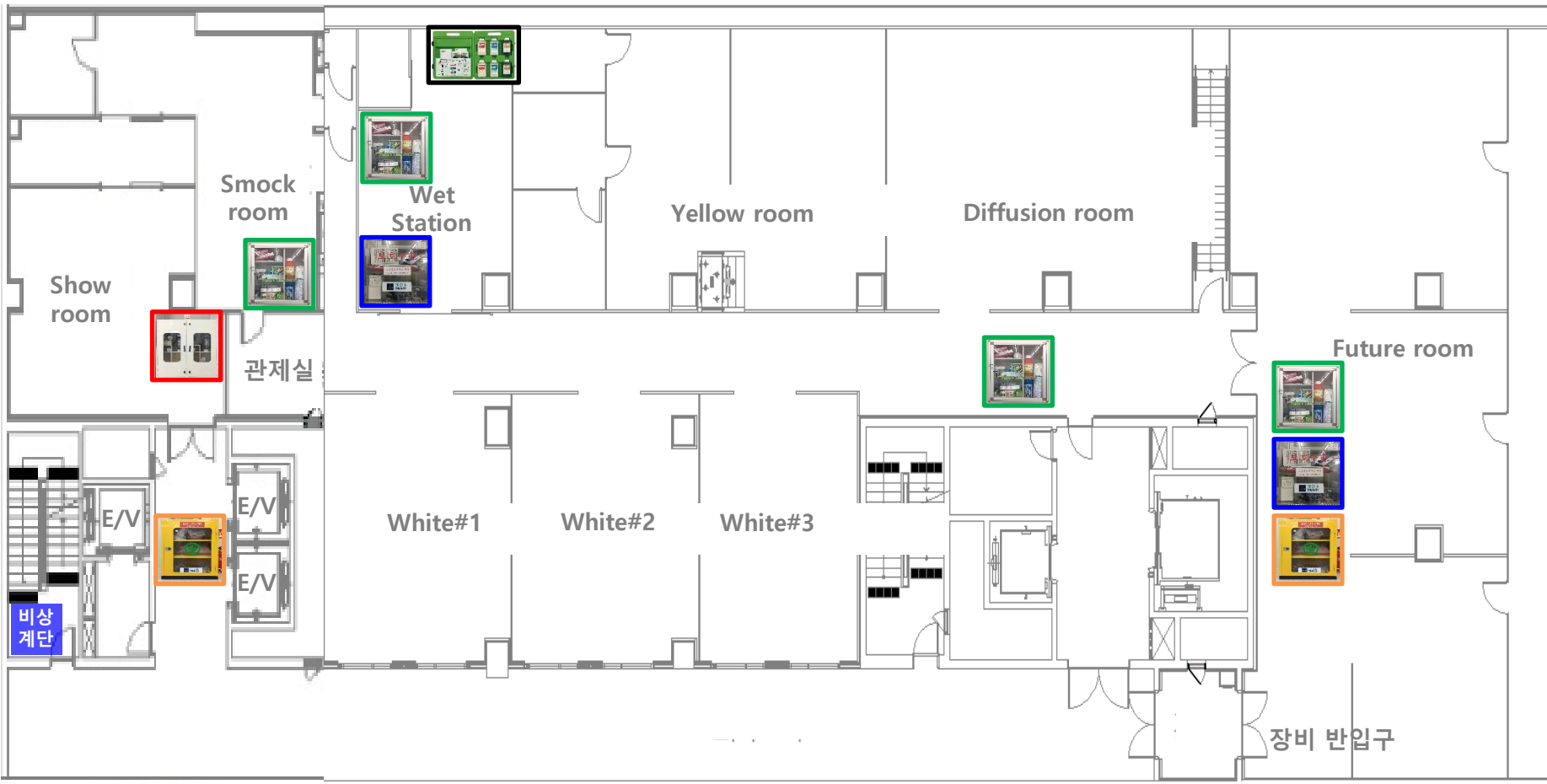


케미컬 중화 키트
중화제(산,염기,유기)
폐기물 처리 용품

★ 비상시 조치 요령

9. 안전 물품 보관 장소

-  비상기구함(1)
-  비상기구함(2)
-  보호구함
-  구급약품함
-  케미컬 중화 키트



주차장
입구

1. 클린룸 정의
2. 시설 이용
3. 보유 장비
4. 공동 이용 수칙
5. 화공약품 취급 요령
6. 비상시 조치 요령
- 7. 장비 예약 / 실적 입력**

★ 입실신청/장비 예약/실적 입력

1. 홈페이지 회원가입 및 자율사용자 등급 신청 (ucrf.unist.ac.kr)

UNIST | UCRF

UNIST member

Industry member

External member

ID/E-mail

m*k*m

@unist.ac.kr

Password

Confirm

Name

홍길동

Department

연구지원본부

Student ID No. /
Professor ID No. /
Staff ID No.

20*39

Contact

Extension

4064

Cell phone

010

Principal Investigator

김교수

Professor Search

Select

Create Account

회원가입 클릭 -> UNIST Member 선택 -> Portal id/pw 입력 후 confirm 클릭
-> 자동으로 아래에 인적사항 뜸 -> 연구책임자 입력 후 search 클릭
-> 해당 연구책임자 클릭 -> Create Account 클릭

Request for Self-user

Nano Fabrication Center

Etching

Deep Si Etcher

Apply

마이페이지 -> 왼쪽하단 자율사용자등업조정요청 클릭
-> 해당창 pop up되면 장비 선택 후 Apply 클릭

장비담당자 권한신청 확인 후 승인하면
UCRF 홈페이지 및 Portal 연구장비에서 예약 신청 가능

입실신청/장비 예약/실적 입력

2. 입실 신청

UNIST Central Research Facilities

About UCRF | Equipment Status | Data Room | **Participation Space**

Equipment Search

Please enter the name of equipment.

Laboratory

Notice

Education & Seminar

Tour Application

Access Permissions Application

Equipment Reservation/Analysis Request

Status of Analysis Request

Download of document related to payment

Status of Education Application

600 MHz FT-NMR

Education & Seminar

Q&A

FAQ

January, 2016

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Notice Archive

Thermal Analysis Notice 2016.01.22

Normal TEM will be repaired 2016.01.20

Normal XRD is working with manual mode only. 2016.01.18

No entry normal TEM room on 1/15 2016.01.14

BET 분석장비의 명칭 변경 (Renamed the BET... 2016.01.12

Procedure

This is the procedure to use the equipment of UCRF. Please ensure the procedure is different by each laboratory.

Discount Criteria

This is the criteria of discount for the use of equipment. Please refer to the specified criteria of discount.

UNIST Central Research Facilities

UCRF Equipment Catalog

We produced a catalog that includes the detailed information of equipment and the result of analysis image.

Details >

UCRF 홈페이지 접속 후 입실 신청

Access Permissions Application

Participation Space > Access Permissions Application

UNFC Entrance Application

UNFC Entrance Application

연구실 명 확인

: UNFC (UCRF Nanofabrication Center)

Advisor			
Department	연구지원본부행정실		
Applicant	김민재		
Contact	Office	Select	- -
	Cell phone	010	- 4848 - 2951
Position	직원		
E-mail	mjkim	@ unist.ac.kr	Select
Date (Period)	☐ 1 day (5,000won) ☐ 1 month (90,000won) ☐ 3 month (180,000won) ☐ 6 month (320,000won) Begin		

일일 출입 및 1/3/6개월 장기 입실 신청 가능
입실 시작일 선택

내용 작성 후 하단 apply 버튼 클릭

입실신청/장비 예약/실적 입력

3. 예 약

Portal -> 연구장비 -> 장비예약 신청/실적 입력 -> 신청

UNIST

연구지원본부행정실 님 | 검색선택 | 환경설정 | 사이트맵 | 로그아웃 Q

KOR ENG

홈 인사급여 재무 구매 자산 예산 **연구장비** 발전기금 지식재산 게시판 환경설정 시스템 개선 요청

장비예약/실적 입력

세부 탐색

장비예약 신청/실적 입력

장비예약자 조회

장비상태조회

Favorite

장비예약신청

도움말

조회조건

조회

예약일자: 2015.01.01 ~ 2015.07.19 ☒ 예약신청 ☐ 실적입력 ☐완료 ☐전체

대분류: 중분류: 장비명:

장비예약리스트

신청

예약취소

실적입력

선택	상태	신청구분	장비명	연구책임자	예약일자	예약시간	사용료	대분류명	중분류명	신청일자	테스트 면제	장기입실 면제	예약메모
☐	예약신청	Self	Photolitho#1(MA6)		2015.07.14	14:00~14:30	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Photo	2015.07.09 10:58	☐	☐	
☐	예약신청	Self	Furnace Oxide		2015.07.13	09:00~17:00	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Thinfil	2015.07.09 10:59	☐	☐	
☐	예약신청	Self	Deep Si Etcher		2015.07.13	09:00~10:00	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Etching	2015.07.09 10:59	☐	☐	

* Self/의뢰건 신청이력 확인 가능, 메모 입력 가능

66

UNIST

FIRST IN
CHANGE

입실신청/장비 예약/실적 입력

3. 예 약

이전화면 신청 클릭시 해당 화면 pop up -> 대/중/소분류로 장비 선택하면 예약시간 선택 가능
시간 선택 후 신청 클릭

3

신청

닫기

접기<->펼치기

장비예약

회원ID: mjkim@unistack.kr

20139 / 홍길동

예약자: 20139 홍길동

1

대분류: UNFC - 나노소자공정실

중분류: Etching

소분류: Deep Si Etcher

과제정보

연구책임자	연구책임자명	세부과제 번호	세제목	집행가능액	신청중금액	사용가능액
100**	김교수			0	0	0

예약제어정보

예약단위시간	일예약가능시간	예약OPEN시점	예약취소가능시점	이용수가
1.000 시간	3.0 시간	14 일전	2 시간전	1.0 OP 150,000 원

유의사항03

Plate backside 오염상태 반드시 확인 후 loading 할 것(Hellium leak err 발생)

유의사항02

사용후 chiller 온도 반드시 room temp(23℃)으로 변경 할 것.

유의사항01

Stop stanby는 sample setting 완료 후 진행 할 것.

시간/날자	07/09(목)	07/10(금)	07/11(토)	07/12(일)	07/13(월)	07/14(화)	07/15(수)	07/16(목)	07/17(금)	07/18(토)	07/19(일)	07/20(월)	07/21(화)	07/22(수)	07/23(목)
00:00~01:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01:00~02:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
02:00~03:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
03:00~04:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04:00~05:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05:00~06:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06:00~07:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07:00~08:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08:00~09:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09:00~10:00	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10:00~11:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11:00~12:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12:00~13:00	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2

대/중/소분류 선택은 홈페이지 자율사용자등급요청 승인 장비에 한해 됨.

입실신청/장비 예약/실적 입력

4. 실적 입력

Portal에서 예약이력 확인 가능, 사용 후 실적 입력

장비예약신청

조회

예약일자: 2015.01.01 ~ 2015.07.19

예약신청

실적입력

완료

전체

대분류:

중분류:

장비명:

장비예약리스트

신청

예약취소

실적입력

해당 행 체크 후 실적입력 클릭

선택	상태	신청구분	장비명	연구책임자	예약일자	예약시간	사용료	대분류명	중분류명	신청일자	테스트 면제	장기입실 면제	예약메모
☒	예약신청	Self	Photolitho#1(MA6)		2015.07.14	14:00~14:30	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Photo	2015.07.09 10:58	☐	☐	
☐	예약신청	Self	Furnace_Oxide		2015.07.13	09:00~17:00	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Thinfilim	2015.07.09 10:59	☐	☐	
☐	예약신청	Self	Deep_Si_Etcher		2015.07.13	09:00~10:00	0.00	UNFC - 나노소자공정실	Etching	2015.07.09 10:59	☐	☐	

사용실적입력

저장

재정8승인

예약정보

예약번호: 2021071904

예약일자: 2021.08.27

의뢰자명: Self

의뢰자회원ID: Potal ID

홍길동

신청일자: 2021.08.27

예약시간: 18:00~18:00

장비명: Deep Si Etcher

과제정보

※학부 및 팀 예산사용시 체크 바람

팀 및 학부예산

외부지원

연구책임자	연구책임자명	세부과제번호	세제목	집행가능액	신청가능액	사용가능액
-	김교수			0	0	

사용비용

비용	단위수량	부과단위	단위금액	합인적용	승선적용	사용수량	사용금액	정가율	합인율적용금액
기본공정료	1.0	OP	150,000	☒		1.0	150,000	50%	75,000
100um 호과시 100um당	1.0	EA	50,000	☒			0	50%	0
4inch glass wafer (Boro33)	1.0	EA	35,000	☐			0	100%	0
합계							150,000		75,000

사용료 면제

가동시간: 2.0

분비시간:

계속 장비 사용 체크

사용	장비명	사용금액
☐	Microscope#1	0
☐	Surface profiler	0
☐	Thickness measurement	0
☐	Ellipsometer	0
☐	He Leak Detector	0
☐	WLI surface & Height Profiler	0

공정조건

Power_Source(W)	Power_Bias(W)	Pressure(mT)
Process time(min)	etching step time(sec)	deposition step time(sec)
SF6(sccm)	CF4(sccm)	O2(sccm)

*실적 입력 시 : 단위수량, 부과단위, 추가요금 기준을 잘 확인하여 입력

사용 실적 입력

공정 조건 입력

입실신청/장비 예약/실적 입력

5. 연구책임자 변경(반도체실습수업 해당)

반도체 실습수업건 연구책임자 변경하여 실적입력 저장(장비예약에서 변경불가)

장비예약신청

조회조건

예약일자: 2022.09.... ~ 2023.05....
 ☒ 예약신청
 ☐ 실적입력
 ☐담당자승인
 ☐책임자승인
 ☐청구완료
 ☐반려

대분류: UNFC - 나노소재공정실
 중분류: Photo
 장비명: Photolitho_MA6#1

장비예약리스트

선택	메모	상태	신청구분	장비명	연구책임자	예약일자	예약시간	사용료	예약자명
☒		예약신청	Self	Photolitho_MA6#1	장유진	2023.03.02	10:30~11:00	0	장유진
☐		예약신청	Self	Photolitho_MA6#1	장유진	2023.03.02	10:00~10:30	0	장유진

2 연구책임자명 검색하여 변경(장유진)

연구책임자

33273

연구책임자

33273

클릭

해당 칸에 커서를 올리면 검색 버튼 나타남

검색: 연구책임자

조회조건

직번:

성명: 장유진

※ 조건중 하나 이상은 반드시 입력해야 합니다.

ID	성명	소속	직책
33273	장유진	반도체 소재 · 부품 대학원	연구원

장비사용실적입력

예약정보

예약번호: 2023015559
 예약일자: 2023.03.10
 의뢰자권한: Self
 신청일자: 2023.03.01
 예약시간: 15:00~16:00
 청구율: 50%

과제정보

※학부 및 팀 예산사용시 체크 바람
 ☐ 팀 및 학부예산
 ☐ 외부지원

변경 확인 후 실적입력 및 저장

연구책임자	연구책임자명	세부과제번호
33273	장유진	

사용비용

비용	단위수량
기본공정료	1.0
6인치 8"wafer head 400mm 기준	1.0

2. 화공약품 반입 신청서

화공약품 반입신청서 (나노소자공정실)

반입	(날짜)			
반출	(날짜)			
신청인	소속		이메일	
	이름		지도교수	
화학약품	순번	1	2	3
	화학약품명			
	분류 (산/염기/유기)			
	수량			
	용량			
	유효기간			
참고사항	1. MSDS에 근거하여 상기 자료를 작성하고, 제조사의 MSDS를 함께 제출 2. 분류 - 산, 염기, 유기 (폐기 - 불산, 황산, 기타산, 염기, PR 등) 3. 화학약품 유효기간 확인 필요 4. 화학약품 통에 아래의 정보(화학약품명, 신청인)를 기재 5. 보관기간 (1년 - 감광제/유기, 6월-산, 알카리) 본인은 울산과학기술원 연구지원본부 나노소자공정실의 안전 관리 규정을 준수합니다. 또한 위 내용에 대한 내용이 정확함을 확인하고 잘못된 정보, 폐액 분류 규정을 지키지 않아서 발생하는 사고에 대하여 연대 책임 질 것에 동의합니다. 신 청 인: (서명) 지도교수: (서명)			

- ※ 작성요령>
- 1. 장비 담당자와 화공약품 반입에 관하여 협의
 - 2. 반입 일자, 반출일자, 신청인, 약품 정보, 서명 후 제출
 - 3. 화공약품 반입 시 매번 제출
 - 4. 양식 UCRF 홈페이지 양식
: 홈페이지 (<https://ucrf.unist.ac.kr/>) 내 자료마당-일반자료실

※ 최장 PR 1년, 이외 chemical 6개월 보관 가능 (유효기간 내)

Chemical	Ex. Acetone	Chemical	
Import (Date)	Ex. 21. 01. 01	Import (Date)	
Export (Date)	Ex. 22. 12. 31	Export (Date)	
Property	Solvent	Property	
Department	UNIST UCRF	Department	
Name	Kang O Kim	Name	
Contact No.	010,****,**** (#4182)	Contact No.	

2. 휴일안전점검일지

연구지원본부 나노소자공정실(클린룸) 휴일 점검 일지

건물(호실)	실험실명	점검 일자	연구활동종사자		
			소속(학부)	점검자	책임자
자연과학관(B101)	나노소자공정실	2019. . .		(인)	(인)

※ □ 네모칸 안 내용만 작성후 담당자에게 제출바랍니다.(□ 외 내용은 휴일전 담당자 점검 진행) 참고 : 정상(O), 이상(X), 수색(△)

항 목		비 고	확 인	특 이 사 항
일반안전	실험실의 청결상태 및 정결상태	확인점검		
	연구실내 금연, 음식을 헌입 및 섭취여부	확인점검		
	비상 연파망 및 비상시 행동요령 비치 상태	확인점검		
	실험 폐기물 관리상태	확인점검		
소방안전	위험표지 및 안전, 경고 표지 부착 여부	확인점검		
	화재물 소화기 적정 비치 및 숙지 여부	확인점검		
	화재경보기의 설치 및 설치장소 숙지여부	확인점검		
	Furnace 및 가열기기 관리 상태	확인점검		
Smock room	양압 뿔뿔 동작 상태	동작점검		
	자동문 동작 상태	동작점검		
White room	Air shower 동작 상태	동작점검		
	장벽 alarm 및 이상 여부	동작점검		
Photo room	누수 및 Gas detector alarm 여부	확인점검		
	Air shower 동작 상태	동작점검		
Wet room (화학안전)	장벽 alarm 및 이상 여부	확인점검		
	물질안전 보건자료(MSDS)의 비치 여부	확인점검		
	약품별 저장용기 및 보관 장소 적정 여부	확인점검		
	약품 위험성 분류에 따라 분류 보관 여부	확인점검		
	흡수, 배기 등 환기시설 관리 및 작동 상태	동작점검		
	폐액통 레벨 상태(Acid)	확인점검		
	폐액통 레벨 상태(HF)	확인점검		
	폐액통 레벨 상태(CMOS)	확인점검		
	폐액통 레벨 상태(Alkali)	확인점검		
	개인 보호 장비 보유 및 사용 상태	확인점검		
전기안전	전기기기의 절연, 파복손상 및 접지 적정여부	확인점검		
	코드, 배선기구의 용량 및 규격 적합 여부	확인점검		
	전열기 주변 가연성물질 등의 방지 여부	확인점검		
기계기구	누전차단기의 설치 및 작동상태	동작점검		
	고온/고압 실험장비 사용시 안전장치 설치상태	동작점검		
서브룸	레이저 등의 광학기구 작동상태	동작점검		
	Gas, water, oil leak 여부	확인점검		
	Burn scrubber 동작 상태	동작점검		
	Power drain 동작 상태	동작점검		
	Pump류 소음(알람) 및 oil leak유무	확인점검		
	폐수 탱크 이상 유무	확인점검		
가스안전 (Gas room)	폐수 처리 장치 동작 상태	동작점검		
	가스캐비닛 알람 여부(이상시 캐비닛 #기재)	동작점검		
	산소 농도 측정기 동작 상태(정상범위 20.9%)	18~23.5%		
	Burn scrubber 동작 상태 및 누수 여부	동작점검		
	가스용기 고정 및 관리(밸브 및 배관) 상태	확인점검		
	미사용 고압가스용기 보호캡 설치여부	확인점검		
	고압가스 용기 충전기한 적정여부	확인점검		

※ 이상 발생시 점검 일자 및 이상 내용을 특이사항에 필히 기재할 것!

※ 작성요령

1. 휴일 연구실 방문 시 모든 이용자 작성 (Smock 룸 비치)
2. 점검 및 작성 후 점검자, 책임자 서명 후 클린룸 담당자에게 제출
3. 양식 UCRF 홈페이지 양식
: 홈페이지 (<https://ucrf.unist.ac.kr/>) 내 자료마당-일반자료실

3. 외부 자율 사용자 서약서

[붙임1]

자율사용 신청 및 서약서

기관명		
기관구분	기업 ☐ / 대학 ☐ / 연구소 ☐ / 기타 ☐	
구분	자율사용 신청자	신청자가 소속한 기관의 책임자
이름		
직급		
이메일		
전화번호		

※ 개인정보 수집·이용 사항 고지: 개인정보보호법 제15조제1항제4호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.

개인정보 처리목적	개인정보 항목	수집 근거
교내시설 이용신청 처리	소속, 직급, 이름, 연락처	「개인정보보호법」 제15조제1항제4호

☐ 서약 내용

- ☒ 신청자 본인은, 울산과학기술원 연구지원본부(UCRF)의 연구장비를 자율사
용하고자 자율사용 자격 취득을 위한 교육 및 평가 과정 이수를 신청합니다.
- ☒ 교육 및 평가와 연구장비 자율사용 과정 중 연구지원본부의 규정·지침·
이용수칙을 숙지하고 준수하겠습니다.
- ☒ 장비 사용시 교육 받은 내용을 준수하고, 특이사항 발생시 담당자와 반드
시 협의하며 연구 장비·시설의 작동과 안전 유지에 협조하겠습니다.
- ☒ 이용기간 동안 자율사용 신청자의 부주의로 발생한 사고, 기기 손상, 고장
및 분실 등에 대해 책임을 지고 보상하겠습니다.

일월년

자율사용 신청자 (인)

소속기관 책임자 (인)

※ 작성요령

1. 유니스트 소속 구성원이 아닌 외부인이 연구지원본부 장비를 자율사용 신청하려는 경우 첨부된 양식의 서약서를 작성, 제출해야 합니다.
2. 어느 장비든 최초 자율사용교육 신청시 제출하면 됩니다.
3. '자율사용 신청 및 서약서' 양식에 자율사용자 본인과 소속기관의 책임자 정보 기입 후 하단 서명 확인하여 제출바랍니다.
4. 홈페이지에 가입된 본인이 아닌 타인의 대리 예약/사용은 금합니다.
5. 실제 교육 신청 및 자율사용 등급 부여는 각 장비담당자에게 문의
6. 양식 : 홈페이지 (<https://ucfr.unist.ac.kr/>) 내 자료마당-일반자료실

- 제출처 : 장비담당자

울산과학기술원 연구지원본부장 귀하

4. 벌점 부과 기준 및 조치

[별표1] 클린룸 사용자 벌점 부과 기준 및 조치

1. 벌점 부과 기준

가. 사용자의 행위가 아래에 해당하는 경우 벌점을 부과한다. (제재 조치 이후 사용을 재개할 때는 이전의 벌점 내역은 1년간 유지되며, 누적점수에 따라 추가 제재를 가할 수 있다.)

구분		벌점
가급 위반 행위	독성가스 또는 유독물질 등 위험물질에 노출 위험을 초래	10
	화재 및 사고 발생 위험을 초래	10
	고의적으로 장비를 훼손하는 행위	10
	폐 시약 통의 보관량이 1/2 이상일 때 관리자에게 통보하지 않는 행위	10
	Wet station 사용 또는 폐액 통(waste tank) 처리 관련 작업 시 안전장구 미착용(고글, 방독면, 앞치마, 보호 장갑, 안전보호구등)	10
	폐액 분류를 올바르게 하지 않는 행위(폐액 종류별 구분)	10
	성상별(산, 유기, 알칼리) 지정 chemical bath를 임의로 변경하는 행위	10
	관리자와 사전 협의 없이 전기, 가스, 소방 및 기타 유틸리티를 조작	10
	기타 타인의 안전에 피해를 줄 수 있는 행위	10
나급 위반 행위	예약 없이 장비 무단사용 또는 예약 시간을 초과하여 무단으로 장비 사용	5
	타인 명의의 출입증을 이용하여 출입	5
	타인의 명의로 예약(로그인)하여 장비 사용	5
	사전 협의 없이 장비를 무리하게 사용	5
	타인의 물품(공정 소모품 및 기자재)을 사전 동의 없이 사용하거나 탈취	5
	클린룸 내에서 관리자에게 승인 받지 않은 화공약품 사용 (약품 반입 신청서 미제출 포함)	5
	화학물질을 사용 후 방치하거나 위험을 초래하는 행위	5
	Wet Station 실험 도중 사용 중인 화학약품의 정보 및 사용 예상시간, 소속, 이름, 연락처 등의 정보를 담은 메모를 남기지 않고 자리이탈 행위	5
	기타 안전에 위해를 가하거나 장비에 피해를 입힐 수 있는 행위, 기타 클린룸 이용 수칙을 위반한 행위	5
다급 위반 행위	장비 사용 후 사용 실적 미 입력 또는 허위 입력 행위	3
	방진복 착용 방법 위반 및 청정도에 영향을 미치는 행위(화장 등)	3
	클린룸에서 사용이 허가되지 않는 물품을 사용하는 행위(청정도 유지)	3
	지정된 후드 외에서 Hot plate 및 약품을 사용하는 행위	3
	교체된 장비 부품, 사용한 공정 소모품, 시편 등을 장시간 방치 행위	3
	안전교육 미 이수자를 관리자의 동의 없이 출입하도록 돕는 행위	3
	약품을 지정되지 않은 위치에 보관하거나 방치하는 행위	3
	물품 및 장비 반입 규정 위반(노트북, 아이패드 등 실험 용도 제외)	3
	클린룸 내부에서 뛰거나, 장비에 기대거나, 바닥에 앉는 행위	3
	기타 클린룸의 실험실 안전 및 타인의 장비사용에 피해를 주어 제재가 필요하다고 판단되는 행위	3

2. 제재 조치

- 가. 누적 벌점이 아래에 해당하는 경우 해당 제재 조치를 취한다.
- 나. 조치 시행시, 해당 내용을 본인과 해당 연구실 연구책임자(지도교수)에게 메일로, 해당 학과에는 공문으로 통보하며 클린룸 게시판에 게시한다.

구분	누적 벌점	조치 내용
개인에게 부과된 누적 벌점	10점	해당 장비 1개월간 사용 정지
	15점	해당 장비 3개월간 사용 정지 또는 클린룸 제반 환경에 피해를 입혔을 경우 1개월간 클린룸 출입 정지
	30점	3개월간 클린룸 출입 정지
동일 연구실 소속 구성원에게 부과된 누적 벌점	40점	해당 연구실 소속 구성원의 1개월간 해당 장비 사용 금지
	50점	해당 연구실 소속 구성원의 1개월간 클린룸 출입 정지

5. 공동 이용 수칙-1

화공약품 안전 수칙

- ☞ 화공약품 취급 시 반드시 안전보호구를 착용한다.
- ☞ 화공약품 구매 또는 취급 시에는 반드시 물질안전보건자료 MSDS를 통해서 물질의 성질 및 위험성을 숙지한다.
- ☞ 화공약품의 저장 시 성상에 따라 유사하거나 상호 간에 반응성이 낮은 약품끼리 보관한다.(산, 염기, 유기로 분류)
- ☞ 화공약품으로 인한 사고 시 환부를 흐르는 물에 최소 15분 이상 씻으며, 관리자에게 반드시 보고한다.
- ☞ 약품을 선반에 보관 시 용량이 큰 약품은 선반 하단에, 선반 위에는 약품 전도 방지를 위한 물리적 조치를 취한다.
- ☞ 실험실의 안전통로는 항상 청결하게 유지하며, 실험실 바닥 면에는 화학약품을 절대 보관 및 방치하지 않는다.
- ☞ 유해물질 등 시약은 절대로 입에 대거나 냄새를 직접 맡지 말아야 한다.
- ☞ 실험대 위에는 필요한 시약만 놓아두고, 가능한 한 필요한 최소량만 보관한다.
- ☞ 화공약품을 별도의 용기에 덜어서 사용할 때에는 반드시 물질명을 명확히 기재하여야 한다.

Fume Hood 관리 수칙

- ☞ 유해한 화공약품, 분진, 가스, 휘발성 물질 등을 취할 때에는 흡 후드를 사용한다.
- ☞ 흡 후드 문은 최소로 개방하여 실험하며, 차압계 및 흘날리기 쉬운 휴지 등으로 음압 상태를 확인한다.
- ☞ 머리와 몸이 후드 안쪽으로 들어가지 않도록 한다.
- ☞ 후드 내부와 유리문은 항상 청결하게 관리한다.
- ☞ 실험에 필요한 화학물질 이외의 가연물질은 보관하지 않는다.
- ☞ 흡 후드 내 전기를 사용하는 경우 콘센트 플러그는 흡 후드 외부에 설치한다.
- ☞ 화학물질 취급 시 적절한 안전보호구(보호장갑, 마스크, 보안경, 보호의 등)를 반드시 착용한다.
- ☞ 흡 후드에 연결되어 있는 냉각수, 급/배수, 가스 밸브 및 배관은 수시로 확인한다.

★ #별첨5

5. 공동 이용 수칙-2

폐기물 관리 수칙

- ☞ 화학폐기물 취급, 보관 장소에서는 금연 및 화기를 엄금한다.
- ☞ 폐기물 수집 시 폐산, 폐알칼리, 폐유기용제, 폐유 등 종류별로 구분수집 및 표기한다.
- ☞ 폐기물 용기는 폐액의 유출이나 악취가 발생되지 않도록 이중 마개를 닫는 등의 조치를 취한다.
- ☞ 폐액 처리 전 물질의 성질을 충분히 조사하여 첨가 약제를 소량씩 투입하는 등 중화, 전 처리한다.
- ☞ 폐액 용기가 전도 및 전락으로 인해 파손되지 않도록 주의한다.
- ☞ 일반폐기물과 지정폐기물은 분리, 폐기한다.
- ☞ 수집한 화학폐기물 용기는 직사광선을 피하고 통풍이 잘 되는 곳을 보관 장소로 지정 보관하여야 하며, 복도 및 계단 등에 방치해서는 안된다.

고압가스 안전 수칙

- ☞ 가스 실린더 및 가스 라인에는 가스 종류를 표시한다.
- ☞ 실린더는 체인 또는 벨트로 벽 또는 실험 벤치 등에 고정하여 전도를 방지한다.
- ☞ 용기 보관 및 운반 시에는 반드시 캡을 씌우도록 한다.
- ☞ 용기 운반 시에는 반드시 카트에 체인을 체결한 후 운반한다.
- ☞ 가연성 가스는 불, 스파크가 발생하는 점화장치가 있는 곳, 화공약품 근처에서 취급하면 안 된다.
- ☞ 가연성, 독성, 부식성 가스의 밸브 나사산, 안전장치, 연결부위 등 수시로 누출검사를 한다.
- ☞ 실린더를 장기간 사용하지 않을 경우 밸브 차단 및 가스 배관 내 모든 압력을 배출하여야 한다.
- ☞ 압력조절기, 라인 등의 연결, 분리 작업 시에는 항상 안전 보호구를 착용한다.
- ☞ 결함이 있는 용기 및 공병은 가스 공급 회사에서 즉시 회수해 가도록 조치한다.



감사합니다.